

10/089602

CT/JP00/06708

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

28.09.00

EKU

JP00/6708

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 9月30日

REC'D 17 NOV 2000

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第279680号

WIPO

PCT

出 願 人

Applicant (s):

日本電気株式会社

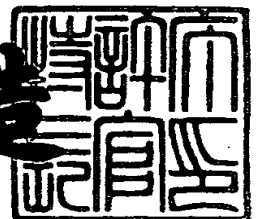
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年11月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3089920

【書類名】 特許願

【整理番号】 51105475

【提出日】 平成11年 9月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01P 1/18

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 丸本 恒久

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064621

【弁理士】

【氏名又は名称】 山川 政樹

【電話番号】 03-3580-0961

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006194

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9718363

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 移相器およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マイクロマシンスイッチのオン／オフ制御により高周波信号の通過位相を切り換える移相器において、

前記マイクロマシンスイッチは、

互いに離間して配置された第 1 および第 2 の分布定数線路と、

前記第 1 または第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、

一端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と前記カンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、

この第 1 の絶縁手段と共に前記第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする移相器。

【請求項 2】 高周波信号が伝搬する主線路と、

この主線路に接続されると共に先端が開放された第 1 の分布定数線路と、

この第 1 の分布定数線路の先端と離間するように配置されかつ先端が開放された第 2 の分布定数線路と、

一端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、

前記第 1 または第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と前記カンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、

この第 1 の絶縁手段と共に前記第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする移相器。

【請求項 3】 高周波信号が伝搬する主線路と、

この主線路に接続されると共に先端が開放された第 1 の分布定数線路と、

この第 1 の分布定数線路の先端と離間するように配置された接地と、

一端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、

前記第 1 または第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と前記カンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、

この第 1 の絶縁手段と共に前記第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする移相器。

【請求項 4】 請求項 2 または 3 記載の移相器において、

前記第 2 の絶縁手段は、前記主線路の途中に形成された 2 個のキャパシタにより構成され、

前記第 1 の分布定数線路および前記第 1 の制御信号線は共に、前記 2 個のキャパシタの間の前記主線路に電氣的に接続されることを特徴とする移相器。

【請求項 5】 請求項 2 記載の移相器において、

前記第 1 の制御信号線は、前記第 2 の分布定数線路に電氣的に接続され、

前記第 2 の絶縁手段は、前記第 2 の分布定数線路の開放された先端により構成されることを特徴とする移相器。

【請求項 6】 寸断箇所のある第 1 の分布定数線路と、互いに電気長の異なる 2 本の第 2 の分布定数線路と、前記第 1 の分布定数線路の寸断箇所を短絡する前記第 2 の分布定数線路を切り換えて高周波信号の通過位相を変化させるマイクロマシンスイッチとを備えた移相器において、

前記マイクロマシンスイッチは、

前記第 2 の分布定数線路毎に設けられ、一端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、

一方の前記第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 2 の制御信号を印加する第 2 の制御信号線と、

他方の前記第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ前記第 2 の制御信号と相補な第 3 の制御信号を印加する第 3 の制御信号線と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と前記各カンチレバーとの対向領域にそれぞれ形成された第 1 の絶縁手段と、

これらの第 1 の絶縁手段と共に前記第 2 および第 3 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備え、

前記第 2 および第 3 の制御信号線により第 1 の制御信号線が構成されることを特徴とする移相器。

【請求項 7】 寸断箇所のある第 1 の分布定数線路と、互いに電気長の異なる 2 本の第 2 の分布定数線路と、前記第 1 の分布定数線路の寸断箇所を短絡する前記第 2 の分布定数線路を切り換えて高周波信号の通過位相を変化させるマイクロマシンスイッチとを備えた移相器において、

前記マイクロマシンスイッチは、

前記第 2 の分布定数線路毎に設けられ、一端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、

前記第 1 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と前記各カンチレバーとの対向領域にそれぞれ形成された第 1 の絶縁手段と、

これらの第 1 の絶縁手段と共に前記第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備え、

前記各第 2 の分布定数線路には前記第 1 の制御信号の 2 状態の各電圧値と同等の定電圧がそれぞれ印加されることを特徴とする移相器。

【請求項 8】 請求項 6 または 7 記載の移相器において、

前記カンチレバーは、前記各第 2 の分布定数線路の両端にそれぞれ設けられることを特徴とする移相器。

【請求項 9】 請求項 1～8 いずれか 1 項記載の移相器において、

前記第 1 の絶縁手段は、前記第 1 および第 2 の分布定数線路の他方の上面と前記カンチレバーの下面の少なくとも一方に形成された絶縁膜であることを特徴とする移相器。

【請求項 10】 請求項 1～9 いずれか 1 項記載の移相器において、

前記第 1 の制御信号線に接続されかつ前記高周波信号の通過を阻止する第 1 の高周波信号阻止手段を備えることを特徴とする移相器。

【請求項 11】 請求項 10 記載の移相器において、

前記第 1 の高周波信号阻止手段は、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続される方に一端が接続されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、

前記高インピーダンス線路の他端に一端が接続されると共に他端が開放されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記高インピーダンス線路の特性インピーダンスよりも小さな特性インピーダンスを有する低インピーダンス線路とからなり、

前記第 1 の制御信号線は、前記高インピーダンス線路の他端に接続されていることを特徴とする移相器。

【請求項 12】 請求項 10 記載の移相器において、

前記第 1 の高周波信号阻止手段は、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続される方に一端が接続されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、

一方の電極が前記高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が接地に接続されたキャパシタとからなり、

前記第 1 の制御信号線は、前記高インピーダンス線路の他端に接続されていることを特徴とする移相器。

【請求項 1 3】 請求項 1 0 記載の移相器において、

前記第 1 の高周波信号阻止手段は、インダクタンス素子からなることを特徴とする移相器。

【請求項 1 4】 請求項 1 0 記載の移相器において、

前記第 1 の高周波信号阻止手段は、前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも十分大きなインピーダンスを有する抵抗素子からなることを特徴とする移相器。

【請求項 1 5】 請求項 1 4 記載の移相器において、

前記抵抗素子は、前記第 1 の制御信号線に直列に挿入されていることを特徴とする移相器。

【請求項 1 6】 請求項 1 4 記載の移相器において、

前記抵抗素子は、一端が前記第 1 の制御信号線に接続されると共に他端が開放されていることを特徴とする移相器。

【請求項 1 7】 請求項 1 ～ 1 6 いずれか 1 項記載の移相器において、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に電氣的に接続されかつ静電誘導により発生する電荷を充放電する第 4 の制御信号線を備えることを特徴とする移相器。

【請求項 1 8】 請求項 1 ～ 1 6 いずれか 1 項記載の移相器において、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に電氣的に接続されかつ前記第 1 の制御信号と逆の極性を有する定電圧を印加する第 4 の制御信号線と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 4 の制御信号線の電氣的に接続される方に形成されかつ前記第 2 の絶縁手段と共に前記第 4 の制御信号線より印加される前記定電圧の電圧値を保持する第 3 の絶縁手段とを備えることを特徴とする移相器。

【請求項 1 9】 請求項 1 7 または 1 8 記載の移相器において、

前記第 4 の制御信号線に接続されかつ前記高周波信号の通過を阻止する第 2 の高周波信号阻止手段を備えることを特徴とする移相器。

【請求項 2 0】 請求項 1 9 記載の移相器において、

前記第 2 の高周波信号阻止手段は、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に一端が接続されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、

一端が前記高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他端が開放されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記高インピーダンス線路の特性インピーダンスよりも小さな特性インピーダンスを有する低インピーダンス線路とからなり、

前記第 4 の制御信号線は、前記高インピーダンス線路の他端に接続されていることを特徴とする移相器。

【請求項 2 1】 請求項 1 9 記載の移相器において、

前記第 2 の高周波信号阻止手段は、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路のうち前記第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に一端が接続されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長で前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、

一方の電極が前記高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が接地に接続されたキャパシタとからなり、

前記第 4 の制御信号線は、前記高インピーダンス線路の他端に接続されていることを特徴とする移相器。

【請求項 2 2】 請求項 1 9 記載の移相器において、

前記第 2 の高周波信号阻止手段は、インダクタンス素子からなることを特徴とする移相器。

【請求項 2 3】 請求項 1 9 記載の移相器において、

前記第 2 の高周波信号阻止手段は、前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも十分大きなインピーダンスを有する抵抗素子からなることを特徴とする移相器。

【請求項 2 4】 請求項 2 3 記載の移相器において、

前記抵抗素子は、前記第 4 の制御信号線に直列に挿入されていることを特徴とする移相器。

【請求項 2 5】 請求項 2 3 記載の移相器において、

前記抵抗素子は、一端が前記第 4 の制御信号線に接続されると共に他端が開放されていることを特徴とする移相器。

【請求項 2 6】 請求項 1 または 2 記載の移相器において、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路にそれぞれの一端が接続されかつ前記高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって前記第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する第 1 および第 2 の高インピーダンス線路と、

一方の電極が前記第 1 の高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が前記第 2 の高インピーダンス線路の他端に接続されたキャパシタとを備え、

前記第 1 の高インピーダンス線路の他端は、前記第 1 の制御信号線に接続され

、
前記第 2 の高インピーダンス線路の他端は、接地に接続されていることを特徴とする移相器。

【請求項 2 7】 基板上に主線路の一部と、この主線路の一部に接続された第 1 の分布定数線路と、端部が前記第 1 の分布定数線路の端部と離間する第 2 の分布定数線路と、前記主線路の一部に接続された制御信号線とを形成する第 1 の工程と、

前記第 1 および第 2 の分布定数線路の隙間から前記第 1 または第 2 の分布定数線路の端部にかけての領域上に犠牲層を形成する第 2 の工程と、

前記犠牲層上における前記第 1 または第 2 の分布定数線路の端部と対向する部分に第 1 の絶縁膜を形成すると共に、前記主線路の一部の両端上に第 2 の絶縁膜を形成する第 3 の工程と、

前記犠牲層が形成されていない前記第 2 または第 1 の分布定数線路の端部から前記犠牲層上の前記第 1 の絶縁膜に至る部分に金属からなるカンチレバーを形成すると同時に、前記第 2 の絶縁膜上から前記基板上に主線路の他部を形成する第

4 の工程と、

前記犠牲層を除去する第 5 の工程とを備えることを特徴とする移相器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スイッチング素子のオン／オフ制御により高周波信号の通過位相を切り換える移相器に関し、特に、スイッチング素子としてマイクロマシンスイッチが使用される移相器に関する。

【0002】

【従来の技術】

最近、移相器に使用されるスイッチング素子について、マイクロマシンスイッチの使用可能性が指摘されている。このマイクロマシンスイッチは、微細に機械加工されたスイッチング素子であり、PIN ダイオードスイッチなどの他の素子に比べて損失が少なく、低コスト・低消費電力であるという特徴を有している。このマイクロマシンスイッチには、例えば特開平 9 - 1 7 3 0 0 号公報記載のものがある。

【0003】

図 3 1 は、公知の移相器に前記公報記載の従来のマイクロマシンスイッチを使用した場合の平面図である。なお、主線路 2 0 1 を伝搬する高周波信号 R F の波長を λ とする。

図 3 1 に示した移相器は、ローデッドライン形の移相器である。すなわち、主線路 2 0 1 には先端開放された 2 本のスタブ 2 0 2 a, 2 0 2 b が互いに $\lambda / 4$ 離れて接続されており、更に、やはり先端開放された別の 2 本のスタブ 2 0 3 a, 2 0 3 b がスタブ 2 0 2 a, 2 0 2 b の先端を離間して配置されている。スタブ 2 0 2 a, 2 0 3 a 間には、コンタクト 2 1 5 を有するマイクロマシンスイッチ 2 0 9 a が配置されており、また、スタブ 2 0 2 b, 2 0 3 b 間には、同じくマイクロマシンスイッチ 2 0 9 b が配置されている。

【0004】

マイクロマシンスイッチ 209 a, 209 b がオフであるとき、主線路 201 にはスタブ 202 a, 202 b のみが装荷される。一方、マイクロマシンスイッチ 209 a, 209 b がオンとなると、マイクロマシンスイッチ 209 a, 209 b のコンタクト 215 を介して、更にスタブ 203 a, 203 b が装荷されることとなる。したがって、マイクロマシンスイッチ 209 a, 209 b をオン/オフ制御することにより、主線路 201 に装荷されるスタブの電気長を変化させることができる。

【0005】

主線路 201 側からみたスタブのサセプタンスは、装荷されるスタブの電気長により変化する。その一方で、このサセプタンスにより主線路 201 の通過位相が変化する。したがって、マイクロマシンスイッチ 209 a, 209 b をオン/オフ制御することにより、主線路 201 を伝搬する高周波信号 RF の移相量を切り換えることができる。

【0006】

次に、図 3 2 および図 3 3 を用いて、図 3 1 に示した従来のマイクロマシンスイッチ 209 b の構成および動作を説明する。図 3 2 は、マイクロマシンスイッチ 209 b を拡大して示す平面図である。図 3 3 は、マイクロマシンスイッチ 209 b の断面図であり、図 3 3 (A) は図 3 2 における C-C' 線方向の断面図、図 3 3 (B) は同じく D-D' 線方向の断面図、図 3 3 (C) は同じく E-E' 線方向の断面図である。

【0007】

スタブ 202 b, 203 b は僅かな隙間を有して、基板 210 上に形成されている。これらのスタブ 202 b, 203 b と離間する基板 210 上の位置に、下部電極 211 が形成されている。また、スタブ 202 b, 203 b の隙間から下部電極 211 への延長線上にあたる基板 210 上の位置に、ポスト 212 が形成されている。

【0008】

ポスト 212 の上面にはアーム 213 の基部が固定されている。このアーム 213 は、ポスト 212 の上面から下部電極 211 の上方を経て、スタブ 202 b

、203bの隙間上方まで延在している。アーム213は絶縁部材により形成される。

アーム213の上面には上部電極214が形成されている。この上部電極214は、ポスト212上から下部電極211上にかけて延在している。

アーム213の先端部下面には、コンタクト215が形成されている。コンタクト215は、スタブ202bの端部上方から、隙間を跨いで、スタブ203bの端部上方まで形成されている。

【0009】

さらに、下部電極211には制御信号線204が接続されている。下部電極211には、この制御線路204より、マイクロマシンスイッチ209bをオン／オフ制御してスタブ202b、203bの接続状態を切り換える制御信号が印加される。

【0010】

下部電極211に制御信号として電圧が印加される場合、例えば正の電圧が印加されると、下部電極211の表面に正電荷が発生すると共に、対向する上部電極214の下面に静電誘導により負電荷が現れ、両者間の吸引力により上部電極214は下部電極211側に引き寄せられる。これによりアーム213が湾曲して、コンタクト215が下方に変位する。そして、コンタクト215がスタブ202b、203bの両方に接触すると、スタブ202b、203bはコンタクト215を介して高周波的に接続される。

また、下部電極211への正の電圧の印加が停止されると、吸引力がなくなるので、アーム213の復元力によりコンタクト215は元の離間した位置に戻る。これにより、スタブ202b、203bが開放される。

【0011】

なお、図31に示したマイクロマシンスイッチ209aも、ここで説明したマイクロマシンスイッチ209bと同様の構成を有しており、同様に動作する。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図31に示した従来のマイクロマシンスイッチ209bは、ス

タブ 2 0 2 b, 2 0 3 b 間を接続／開放するコンタクト 2 1 5 以外に、コンタクト 2 1 5 を支持するためにポスト 2 1 2 とアーム 2 1 3 とが必要であり、またコンタクト 2 1 5 の変位を制御するために更に下部電極 2 1 1 と上部電極 2 1 4 とが必要である。このため、マイクロマシンスイッチ 2 0 9 b は大きく、立体構造が複雑であった。マイクロマシンスイッチ 2 0 9 a についても同様である。

【 0 0 1 3 】

このようなマイクロマシンスイッチ 2 0 9 a, 2 0 9 b を移相器に使用しては、マイクロマシンスイッチ 2 0 9 a, 2 0 9 b を配置するために大面積が必要となり、移相器全体の大型化を招くという問題があった。また、複雑な構造を有するマイクロマシンスイッチ 2 0 9 a, 2 0 9 b を製造するためには多くの工程が必要であり、移相器の製造プロセスが複雑化するという問題があった。

【 0 0 1 4 】

本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、スイッチング素子としてマイクロマシンスイッチを使用する移相器を小型化することにある。

また、他の目的は、スイッチング素子としてマイクロマシンスイッチを使用する移相器の構造を簡単化することにある。

【 0 0 1 5 】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明の移相器は、マイクロマシンスイッチのオン／オフ制御により高周波信号の通過位相を切り換える移相器において、マイクロマシンスイッチは、互いに離間して配置された第 1 および第 2 の分布定数線路と、第 1 または第 2 の分布定数線路に電気的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、一端が第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方とカンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、この第 1 の絶縁手段と共に第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする。

マイクロマシンスイッチのカンチレバーは可動接点としての機能と、可動接点の支持手段としての機能とを兼ね備えている。したがって、このカンチレバーは機能的に見て従来のマイクロマシンスイッチにおけるコンタクト 215 とアーム 213 とポスト 212 とに相当するが、前者は後者に比べて小さく形成でき、また構造も簡単である。

また、第 1 の制御信号を第 1 または第 2 の分布定数線路に印加してカンチレバーの動作を制御するようにしたので、従来必要であった下部電極 211 および上部電極 214 は不要となり、この点でも小型化できると共に構造が簡単になる。

その一方で、本発明では容量結合用の第 1 の絶縁手段と、制御電圧保持用の第 2 の絶縁手段とが必須要件となる。しかし、本発明によりマイクロマシンスイッチを使用する移相器を小型化できると共に、その構造を全体として簡単化できる。

【0016】

また、本発明の移相器は、高周波信号が伝搬する主線路と、この主線路に接続されると共に先端が開放された第 1 の分布定数線路と、この第 1 の分布定数線路の先端と離間するように配置されかつ先端が開放された第 2 の分布定数線路と、一端が第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、第 1 または第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方とカンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、この第 1 の絶縁手段と共に第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする。

あるいは、本発明の移相器は、高周波信号が伝搬する主線路と、この主線路に接続されると共に先端が開放された第 1 の分布定数線路と、この第 1 の分布定数線路の先端と離間するように配置された接地と、一端が第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、第 1 または第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制

御信号を印加する第 1 の制御信号線と、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方とカンチレバーとの対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、この第 1 の絶縁手段と共に第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備えることを特徴とする。

これらにより、ローデッドライン形の移相器を構成することができる。

【0017】

ローデッドライン形の移相器が構成される場合、第 2 の絶縁手段は、主線路の途中に形成された 2 個のキャパシタにより構成され、第 1 の分布定数線路および第 1 の制御信号線は共に、2 個のキャパシタの間の主線路に電氣的に接続されるようにする。

あるいは、第 1 の制御信号線は、第 2 の分布定数線路に電氣的に接続され、第 2 の絶縁手段は、第 2 の分布定数線路の開放された先端により構成されるものとしてもよい。

【0018】

また、本発明の移相器は、寸断箇所のある第 1 の分布定数線路と、互いに電気長の異なる 2 本の第 2 の分布定数線路と、第 1 の分布定数線路の寸断箇所を短絡する第 2 の分布定数線路を切り換えて高周波信号の通過位相を変化させるマイクロマシンスイッチとを備えた移相器において、マイクロマシンスイッチは、第 2 の分布定数線路毎に設けられ、一端が第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、一方の第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 2 の制御信号を印加する第 2 の制御信号線と、他方の第 2 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ第 2 の制御信号と相補な第 3 の制御信号を印加する第 3 の制御信号線と、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と各カンチレバーとの対向領域にそれぞれ形成された第 1 の絶縁手段と、これらの第 1 の絶縁手段と共に第 2 および第 3 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備え、第 2 および第 3 の制御信号線により第 1 の制御信号線が構成されることを特徴とする。

あるいは、本発明の移相器は、寸断箇所のある第 1 の分布定数線路と、互いに

電気長の異なる 2 本の第 2 の分布定数線路と、第 1 の分布定数線路の寸断箇所を短絡する第 2 の分布定数線路を切り換えて高周波信号の通過位相を変化させるマイクロマシンスイッチとを備えた移相器において、マイクロマシンスイッチは、第 2 の分布定数線路毎に設けられ、一端が第 1 および第 2 の分布定数線路の一方に固定されると共に他端が第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と接離自在となるように形成されかつ導電性部材を含むカンチレバーと、第 1 の分布定数線路に電氣的に接続されかつ電圧の 2 値変化からなる第 1 の制御信号を印加する第 1 の制御信号線と、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方と各カンチレバーとの対向領域にそれぞれ形成された第 1 の絶縁手段と、これらの第 1 の絶縁手段と共に第 1 の制御信号の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段とを備え、各第 2 の分布定数線路には第 1 の制御信号の 2 状態の各電圧値と同等の定電圧がそれぞれ印加されることを特徴とする。

これらにより、スイッチドライン形の移相器を構成することができる。

これらの場合、カンチレバーは、各第 2 の分布定数線路の両端にそれぞれ設けられるようにしてもよい。

【0019】

以上の場合、第 1 の絶縁手段の構成例は、第 1 および第 2 の分布定数線路の他方の上面とカンチレバーの下面の少なくとも一方に形成された絶縁膜である。

これにより、第 1 の絶縁手段を簡単に構成できる。

【0020】

また、前述した移相器は、第 1 の制御信号線に接続されかつ高周波信号の通過を阻止する第 1 の高周波信号阻止手段を備えるようにしてもよい。

この場合、第 1 の高周波信号阻止手段の第 1 構成例は、第 1 および第 2 の分布定数線路のうち第 1 の制御信号線が電氣的に接続される方に一端が接続されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、高インピーダンス線路の他端に一端が接続されると共に他端が開放されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって高インピーダンス線路の特性インピーダンスよりも小さな特性インピーダンスを有する低インピーダンス線路

とからなり、第 1 の制御信号線は、高インピーダンス線路の他端に接続されている。

また、第 1 の高周波信号阻止手段の第 2 構成例は、第 1 および第 2 の分布定数線路のうち第 1 の制御信号線が電氣的に接続される方に一端が接続されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、一方の電極が高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が接地に接続されたキャパシタとからなり、第 1 の制御信号線は、高インピーダンス線路の他端に接続されている。

また、第 1 の高周波信号阻止手段の第 3 構成例は、インダクタンス素子からなる。

また、第 1 の高周波信号阻止手段の第 4 構成例は、第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも十分大きなインピーダンスを有する抵抗素子からなる。この場合、抵抗素子は、第 1 の制御信号線に直列に挿入されていてもよい。あるいは、抵抗素子は、一端が第 1 の制御信号線に接続されると共に他端が開放されていてもよい。

このように第 1 の制御信号線に上記のような第 1 の高周波信号阻止手段を設けることにより、第 1 の制御信号線への高周波信号の漏洩を防止できる。

【0021】

また、前述した移相器は、第 1 および第 2 の分布定数線路のうち第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に電氣的に接続されかつ静電誘導により発生する電荷を充放電する第 4 の制御信号線を備えるようにしてもよい。

このように、静電誘導により発生する電荷が第 4 の制御信号線を介して充放電されることにより、スイッチング動作が安定すると共に、スイッチング速度が速くなる。

【0022】

また、前述した移相器は、第 1 および第 2 の分布定数線路のうち第 1 の制御信号線が電氣的に接続されていない方に電氣的に接続されかつ第 1 の制御信号と逆の極性を有する定電圧を印加する第 4 の制御信号線と、第 1 および第 2 の分布定

数線路のうち第4の制御信号線の電氣的に接続される方に形成されかつ第1の絶縁手段と共に第4の制御信号線より印加される定電圧の電圧値を保持する第3の絶縁手段とを備えるようにしてもよい。

このように、第1の制御信号が印加されない方の分布定数線路に予め所定の電圧をかけておけば、そのぶん第1の制御信号の電圧の大きさを小さくすることができる。

【0023】

これら2形態で、第4の制御信号線に接続されかつ高周波信号の通過を阻止する第2の高周波信号阻止手段を備えるようにしてもよい。

この場合、第2の高周波信号阻止手段の第1構成例は、第1および第2の分布定数線路のうち第1の制御信号線が電氣的に接続されていない方に一端が接続されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって第1および第2の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、一端が高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他端が開放されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって高インピーダンス線路の特性インピーダンスよりも小さな特性インピーダンスを有する低インピーダンス線路とからなり、第4の制御信号線は、高インピーダンス線路の他端に接続されている。

また、第2の高周波信号阻止手段の第2構成例は、第1および第2の分布定数線路のうち第1の制御信号線が電氣的に接続されていない方に一端が接続されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長で第1および第2の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する高インピーダンス線路と、一方の電極が高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が接地に接続されたキャパシタとからなり、第4の制御信号線は、高インピーダンス線路の他端に接続されている。

また、第2の高周波信号阻止手段の第3構成例は、インダクタンス素子からなる。

また、第2の高周波信号阻止手段の第4構成例は、第1および第2の分布定数線路の特性インピーダンスよりも十分大きなインピーダンスを有する抵抗素子か

らなる。この場合、抵抗素子は、第 4 の制御信号線に直列に挿入されていてもよい。あるいは、抵抗素子は、一端が第 4 の制御信号線に接続されると共に他端が開放されていてもよい。

第 4 の制御信号線に上記のような第 2 の高周波信号阻止手段を設けることにより、第 4 の制御信号線への高周波信号の漏洩を防止できる。

【0024】

また、前述した移相器は、第 1 および第 2 の分布定数線路にそれぞれの一端が接続されかつ高周波信号の波長の約 $1/4$ の電気長であって第 1 および第 2 の分布定数線路の特性インピーダンスよりも大きな特性インピーダンスを有する第 1 および第 2 の高インピーダンス線路と、一方の電極が第 1 の高インピーダンス線路の他端に接続されると共に他方の電極が第 2 の高インピーダンス線路の他端に接続されたキャパシタとを備え、第 1 の高インピーダンス線路の他端は、第 1 の制御信号線に接続され、第 2 の高インピーダンス線路の他端は、接地に接続されているものとしてもよい。

この構成において、第 1 の高インピーダンス線路と、キャパシタと、接地とにより第 1 の高周波信号阻止手段が構成される。また、第 2 の高インピーダンス線路を接地に接続することにより第 2 の高周波信号阻止手段が構成される。

【0025】

また、本発明の移相器の製造方法は、基板上に主線路の一部と、この主線路の一部に接続された第 1 の分布定数線路と、端部が第 1 の分布定数線路の端部と離間する第 2 の分布定数線路と、主線路の一部に接続された制御信号線とを形成する第 1 の工程と、第 1 および第 2 の分布定数線路の隙間から第 1 または第 2 の分布定数線路の端部にかけての領域上に犠牲層を形成する第 2 の工程と、犠牲層上における第 1 または第 2 の分布定数線路の端部と対向する部分に第 1 の絶縁膜を形成すると共に、主線路の一部の両端上に第 2 の絶縁膜を形成する第 3 の工程と、犠牲層が形成されていない第 2 または第 1 の分布定数線路の端部から犠牲層上の第 1 の絶縁膜に至る部分に金属からなるカンチレバーを形成すると同時に、第 2 の絶縁膜上から基板上に主線路の他部を形成する第 4 の工程と、犠牲層を除去する第 5 の工程とを備えることを特徴とする。

これにより、前述したマイクロマシンスイッチを少ない工程で製造できる。

【 0 0 2 6 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

（第 1 の実施の形態）

図 1 は、本発明による移相器の第 1 の実施の形態を示す図であり、図 1 (A) は回路図、図 1 (B) は平面図である。また、図 2 は、図 1 に示した移相器の断面図であり、図 2 (A) は図 1 (B) における IIA-IIA' 線方向の断面図、図 2 (B) は図 2 (A) における IIB 部の拡大断面図である。また、図 3 は、図 1 に示した移相器の変形例を示す回路図である。また、図 4 は、図 2 に示した第 1 の絶縁手段の変形例を示す断面図である。また、図 5 は、図 1 に示したカンチレバーの変形例を示す断面図である。

【 0 0 2 7 】

図 1 に示すように、高周波信号 R F が伝搬する主線路 1 は、線路 1 a, 1 b, 1 c により構成される。ただし、線路 1 b の両端にはそれぞれキャパシタ 1 5 a, 1 5 b が形成されており、線路 1 a と線路 1 b とはキャパシタ 1 5 a を介して、また線路 1 b と線路 1 c とはキャパシタ 1 5 b を介して、それぞれ高周波的に接続されている。

キャパシタ 1 5 a は、例えば図 1 (B) に示すように、線路 1 a と線路 1 b とを上下に重ね合わせ、その間に S i O₂ などの絶縁膜 1 6 a を介挿することにより構成される。キャパシタ 1 5 b も同様に、線路 1 b と線路 1 c との間に絶縁膜 1 6 b を介挿することにより構成される。

【 0 0 2 8 】

これらのキャパシタ 1 5 a, 1 5 b は、線路 1 a, 1 c に接続された他のマイクロ波回路（図示せず）を線路 1 b から直流ないし低周波的に絶縁する第 2 の絶縁手段としての機能を有している。したがって、線路 1 a, 1 c に接続された他のマイクロ波回路に含まれる結合コンデンサなどを、第 2 の絶縁手段として利用してもよい。

また、第 2 の絶縁手段は、スタブ 2 a, 3 a の接続時（オン時）に、後述する

第1の絶縁手段と共に、スタブ2 a, 2 bの電圧値を後述する制御信号Sの電圧値に保持するための機能も有している。

なお、図3に示すように、線路1 bの途中に別のマイクロ波回路9 1が接続されていてもよい。

【0029】

図1に示すように、主線路1の一部である線路1 bには、先端開放された2本のスタブ（第1の分布定数線路）2 a, 2 bが互いに $\lambda/4$ 離れて接続されている。ここで、 λ は高周波信号RFの波長である。さらに、やはり先端開放された別の2本のスタブ（第2の分布定数線路）3 a, 3 bが、スタブ2 a, 2 bの先端と離間して配置されいている。

ここで、スタブ2 a, 2 bの電気長をL 1、スタブ3 a, 3 bの電気長をL 2、スタブ2 a, 2 bおよびスタブ3 a, 3 b間の隙間をGとおく。

【0030】

以上の主線路1およびスタブ2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、図2（A）に示すように、基板1 0上に、例えばA 1などの金属からなるマイクロストリップ線路により形成される。なお、主線路1およびスタブ2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、コープレーナ線路、トリプレート線路およびスロット線路などの他の分布定数線路により形成されてもよい。

また、基板1 0には、例えばガラス基板などの誘電体基板、またはSi, GaAs基板などの半導体基板が使用される。

【0031】

スタブ3 aの端部（スタブ2 a側端部）には、A 1などの導電性部材を含むポスト1 2が形成されている。

さらにポスト1 2の上面にはアーム1 3の基部が固定されている。このアーム1 3は、ポスト1 2の上面からスタブ2 aの先端部の上方まで延在している。アーム1 3は、導電性を有し、かつ一度湾曲しても元の形状に復元するような材料で形成される。例えば、A 1、Au、Cuなどで形成される。また、ボロンなどを拡散して導電性をもたせたシリコンなどを用いてもよい。

ポスト1 2とアーム1 3とを合わせてカンチレバー1 1 aと呼ぶ。

【0032】

ポスト12およびアーム13は、図5および図6を用いて後述するように、同一材料による単一部材としてカンチレバー11aを構成してもよい。また逆に、図2に示すように、必ずしもポスト12とアーム13とが同一材料により構成される必要はない。

さらに、ポスト12およびアーム13の各々も、必ずしも単一の材料のみで形成される必要はなく、複数の材料により形成されてもよい。また、この場合、複数の材料のすべてが導電性を有している必要もなく、絶縁体が一部に含まれていてもかまわない。例えば、アーム13が強度上の理由などによりA1などの導体と SiO_2 などの絶縁体とが積層された2層構造となってもよいし、ポスト12も高周波信号RFの伝搬を妨げない程度に絶縁体を含んでいてもよい。

【0033】

図2に示すように、アーム13の先端部下面、すなわちスタブ2aと対向する部分には、第1の絶縁手段として SiO_2 などの絶縁膜14が形成されている。アーム13はポスト12により所定の高さを与えられており、アーム13に取り付けられた絶縁膜14は通常（オフ時）は、スタブ2aと離間している。逆に言えば、絶縁膜14とスタブ2aとが通常離間するように、ポスト13の高さが決められる。

【0034】

第1の絶縁手段は、スタブ2a、3aの接続時（オン時）に、キャパシタ15a、15bと共に、スタブ2aの電圧値を後述する制御信号Sの電圧値に保持するためのものである。したがって、第1の絶縁手段として、図4に示すような、スタブ2aの先端部上面に形成された絶縁膜14aを用いてもよい。また、絶縁膜14と14aとを組み合わせ、第1の絶縁手段としてもよい。

なお、スタブ2aの電圧値が制御信号Sの電圧値に完全一致している必要はなく、カンチレバー11が制御信号Sに基づいて動作できる程度にスタブ2aの電圧値が保持されればよい。

【0035】

また、図2ではカンチレバー11aのスタブ3a側が固定された構造となつて

いるが、これとは逆に図 5 に示すようにカンチレバー 1 1 a' のスタブ 2 a 側が固定された構造となっていてよい。いずれにせよ、カンチレバー 1 1 a, 1 1 a' は、一端がスタブ 2 a, 3 a の一方に固定されると共に、他端がスタブ 2 a, 3 a の他方と接離自在となるような構造を有していればよい。

また、図 1 に示すように、スタブ 2 b, 3 b 側にもスタブ 2 a, 3 a 側と同様に、カンチレバー 1 1 b および絶縁膜 1 4, 1 4 a が形成されている。

【 0 0 3 6 】

また、主線路 1 の一部である線路 1 b には、第 1 の制御信号線 4 を介して制御装置 5 が接続されている。制御装置 5 は電圧の 2 値変化からなる制御信号（第 1 の制御信号）S を出力するものである。後述するように、この制御信号 S に基づきスタブ 2 a, 2 b とスタブ 3 a, 3 b との接続状態が切り換えられる。

なお、第 1 の制御信号線 4 は線路 1 b に直接接続されていなくてもよく、例えば後掲の図 1 0 および図 1 1 に示すように、線路 1 b に電氣的に接続されていればよい。

以上により、ローデッドライン形の移相器が構成される。

【 0 0 3 7 】

次に、図 1 に示した移相器でスイッチング素子として機能するマイクロマシンスイッチの動作を説明する。ただし、説明の都合上、制御信号 S は正の電圧のオン／オフからなるものとする。なお、スタブ 2 a, 3 a 側の符号を挙げて説明するが、スタブ 2 b, 3 b 側も同時に同じ動作を行うことを断っておく。

【 0 0 3 8 】

前述したとおり、通常時、アーム 1 3 先端の絶縁膜 1 4 はスタブ 2 a と離間しているので、スタブ 2 a, 3 a の高周波接続は開放されている。

このとき、制御装置 5 から第 1 の制御信号線 4 を介して線路 1 b に正の電圧が印加されると、線路 1 b に接続されたスタブ 2 a の表面に正電荷が発生する。これにより、このスタブ 2 a と対向するアーム 1 3 の先端部下面に静電誘導により負電荷が現れ、スタブ 2 a とアーム 1 3 との間に吸引力が発生する。この力によりアーム 1 3 は基板 1 0 側に湾曲して、アーム 1 3 の先端部に形成された絶縁膜 1 4 がスタブ 2 a と接触すると、容量結合によりスタブ 2 a とスタブ 3 a とが高

周波的に接続される。

【0039】

このとき、キャパシタ 15 a, 15 b により線路 1 b は線路 1 a, 1 c、さらには線路 1 a, 1 c に接続された他のマイクロ波回路（図示せず）と直流ないし低周波的に絶縁されている。このため、線路 1 b に与えられた制御信号 S が他のマイクロ波回路へ漏れることはなく、他のマイクロ波回路に悪影響を与えることはない。これと同時に、キャパシタ 15 a, 15 b および絶縁膜 14 に囲まれた線路 1 b およびスタブ 2 a の電圧値は保持される。

一方、線路 1 b への電圧の印加が停止されると、スタブ 2 a とアーム 13 との間の吸引力がなくなる。このため、アーム 13 は元の形状に戻るので、再び絶縁膜 14 はスタブ 2 a と離間する。これにより、スタブ 2 a, 3 a の高周波接続が開放される。

【0040】

次に、図 2 (B) を参照して、マイクロマシンスイッチの各部の寸法の一例を示す。ここで、アーム 13 は A1 で形成され、制御信号 S として 40 V の電圧が印加されるものとする。

まず、アーム 13 の強度の関係上、所望のバネ定数を得るために、アーム 13 の厚み t は $0.5 \mu\text{m}$ 程度に決められる。

また、スタブ 2 a の上面からアーム 13 に形成された絶縁膜 14 までの通常時の高さ H は $5 \mu\text{m}$ 程度である。さらに、スタブ 2 a とアーム 13 との対向面積は 0.01 mm^2 程度である。

このように諸寸法を設定することにより、前述したように動作するマイクロマシンスイッチを実現できる。なお、ここで挙げた各部の寸法はあくまで例示であって、これに限定されるものではない。

【0041】

次に、図 1 に示した移相器全体の動作原理を説明する。

制御装置 5 から出力される制御信号 S がオフであり、スタブ 2 a, 3 a およびスタブ 2 b, 3 b の高周波接続がいずれも開放されているとき、線路 1 a ~ 1 c からなる主線路 1 には電気長 L_1 のスタブ 2 a, 2 b のみが装荷される。

一方、制御信号 S がオンとなり、スタブ 2 a, 3 a およびスタブ 2 b, 3 b がいずれも高周波的に接続されると、主線路 1 にはカンチレバー 11 a, 11 b を介して、さらにスタブ 3 a, 3 b が装荷される。このとき、主線路 1 に装荷されるスタブの電気長は $L_1 + L_2 + G$ となる。

したがって、制御信号 S のオン/オフにより、主線路 1 に装荷されるスタブの電気長を変化させることができる。

【0042】

主線路 1 からみたスタブのサセプタンスは装荷されるスタブの電気長により変化する。その一方で、このサセプタンスにより主線路 1 の通過位相が変化する。したがって、制御信号 S をオン/オフしてスタブ 2 a, 3 a およびスタブ 2 b, 3 b の高周波接続を制御することにより、主線路 1 を伝搬する高周波信号 RF の移相量を切り換えることができる。

なお、主線路 1 の途中にはキャパシタ 15 a, 15 b が挿入されているが、容量を十分大きくすれば高周波信号 RF の伝搬には何ら支障がない。

【0043】

次に、図 1 に示した移相器の製造方法について説明する。図 6 および図 7 はこの移相器を製造する際の主要な工程を示す断面図である。これらの図には、図 1 (B) における IIA-IIA' 線方向の断面が示されている。

まず、基板 10 上にフォトレジストを塗布する。このフォトレジストを公知のフォトリソグラフィ技術でパターンニングし、所定の位置に溝 21 a を備えたレジストパターン 21 を形成する。なお、図 6 (A) には後の工程でスタブ 2 a, 3 a および線路 1 b が形成される部分の溝 21 a が示されているが、スタブ 2 b, 3 b および第 1 の制御信号線 4 が形成される部分にも同時に溝が形成されている。

【0044】

次に、図 6 (B) に示すように、基板 10 上の全域にスパッタ法で A1 などからなる金属膜 22 を形成する。

そして、有機溶剤などに溶解させる方法などによりレジストパターン 21 を除去することで、レジストパターン 21 上の金属膜 22 を選択的に除去（リフトオ

フ) し、図 6 (C) に示すように基板 10 上にスタブ 2 a, 3 a および線路 1 b を形成する。図示しないが、このとき、スタブ 2 b, 3 b および第 1 の制御信号線 4 も同時に形成される。

【0045】

次に、図 6 (D) に示すように、感光性を有するポリイミドを塗布して乾燥させ、基板 10 上の全域に膜厚 5 ~ 6 μm 程度の犠牲層 23 を形成する。

そして、公知のフォトリソグラフィ技術を用いて図 6 (E) に示すように犠牲層 23 をパターンニングし、スタブ 2 a, 3 a の隙間からスタブ 2 a の先端部 (スタブ 3 a 側の端部) にかけて (すなわち、図 1 に示したアーム 13 が形成される部分) の犠牲層 23 を残して、不要部分を除去する。なお、図 6 (E) では、スタブ 3 a の端部を除く部分にも犠牲層 23 を残してある。また、図示しないが、スタブ 2 b, 3 b 側の犠牲層も同様にパターンニングされる。

ここで、200 ~ 300℃ に加熱して、残された犠牲層 23 を硬化させる。

【0046】

次に、図 7 (A) に示すように、基板 10 上の全域に CVD 法またはスパッタ法などの手段により SiO_2 を堆積して、膜厚 0.01 ~ 0.3 μm 程度の絶縁膜 24 を形成する。

そして、公知のフォトリソグラフィ技術とエッチング技術を用いて、所定の箇所を残して絶縁膜 24 を除去する。こうして、図 7 (B) に示すように、犠牲層 23 上におけるスタブ 2 a の先端部と対向する部分に絶縁膜 (第 1 の絶縁膜) 14 を形成し、スタブ 2 a との接続点である線路 1 b の端部に絶縁膜 (第 2 の絶縁膜) 16 a を形成する。図示しないが、このとき、スタブ 2 b, 3 b 側にも同様に絶縁膜 (第 1 の絶縁膜) 14 および絶縁膜 (第 2 の絶縁膜) 16 b が形成される。

なお、ここで使用されたフォトリジストはアルカリ溶剤で除去される。

【0047】

次に、図 7 (C) に示すように、スタブ 3 a の端部から犠牲層 14 上の絶縁膜 14 まで至る部分に Al などからなるカンチレバー 11 a を、また絶縁膜 16 a 上から基板 10 上をはうように Al などからなる線路 1 a を、リフトオフ法を用

いて同時に形成する。また、図示しないが同様に、カンチレバー 11b および線路 1c も同時に形成される。

最後に、酸素ガスのプラズマを用いたドライエッチング法で、図 7 (D) に示すように、犠牲層 23 のみを選択的に除去することにより、移相器が完成する。

ここではカンチレバー 11a, 11b を構成するポスト 12 とアーム 13 とを同一工程で形成する方法を示したが、もちろん、ポスト 12 とアーム 13 とを別々の工程で形成してもよい。

【0048】

ここで、図 1 に示した移相器と図 3 1 に示した従来の移相器とを、マイクロマシンスイッチの構成を中心に対比する。

まず、図 1 に示したマイクロマシンスイッチのカンチレバー 11a, 11b は、可動接点としての機能と、可動接点の支持手段としての機能とを兼ね備えている。したがって、カンチレバー 11a, 11b は機能的にみて、図 3 1 に示したマイクロマシンスイッチのコンタクト 215 とアーム 213 とポスト 212 とに相当するが、前者は後者に比べて小さく形成でき、また構造も簡単である。

また、カンチレバー 11a, 11b はポスト 12 とアーム 13 とにより構成されるが、図 7 (C) で示したようにポスト 12 とアーム 13 とは同一工程で形成できるので、カンチレバー 11a, 11b の形成は極めて容易である。

【0049】

また、図 1 に示したマイクロマシンスイッチでは、制御信号 S を主線路 1 の一部である線路 1b に印加してカンチレバー 11a, 11b の動作を制御するようにしたので、従来必要であった下部電極 211 および上部電極 214 は不要となり、この点でもマイクロマシンスイッチを小型化できると共に、マイクロマシンスイッチの構造が簡単になる。

【0050】

その一方で、図 1 に示したマイクロマシンスイッチでは制御信号 S の電圧値を保持するために絶縁膜 14, 16a, 16b が必要になるが、従来のマイクロマシンスイッチでも容量結合形の場合にはコンタクト 215 の下面に絶縁膜を形成する必要があった。また、図 7 (B), (C) で示したように、絶縁膜 16a,

16bを絶縁膜14と同一工程で形成でき、また主線路1の他の一部である線路1a, 1cをカンチレバー11a, 11bと同一工程で形成できるので、製造工程が複雑になるわけではない。

【0051】

以上のように、マイクロマシンスイッチを小型化できると共に、その構造を簡単化できるので、このマイクロマシンスイッチをスイッチング素子として使用することによって、従来よりも移相器を全体として小型化できると共に、少ない工程で移相器を形成できる。

【0052】

(第2の実施の形態)

図8は、本発明による移相器の第2の実施の形態を示す図であり、図8(A)は回路図、図8(B)は平面図である。この図において、図1と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図1に示した移相器と図8に示した移相器とでは、第1の制御信号線4の接続位置が異なる。すなわち、図1に示した移相器では、第1の制御信号線4が主線路1に接続されているのに対して、図8に示した移相器では、第1の制御信号線4がスタブ3a, 3bに接続されている。

【0053】

スタブ3a, 3bは先端部が開放されており、他のマイクロ波回路に接続されていない。このため、図8に示した移相器では、図1に示したキャパシタ15a, 15bのような構成を設けるまでもなく、スタブ3a, 3bの開放された先端部が第2の絶縁手段として機能する。したがって、図8に示すように構成することによって、移相器の構造がより簡単になる。

【0054】

(第3の実施の形態)

図9は、本発明による移相器の第3の実施の形態の構成を示す回路図である。この図において、図1と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図9に示した移相器は、図1に示した移相器の第1の制御信号線4に第1の高

周波信号阻止手段 6 を接続したものである。第 1 の高周波信号阻止手段 6 は、高周波信号 R F の通過を阻止するものである。したがって、主線路 1 を伝搬する高周波信号 R F の制御装置 5 への流入を阻止でき、移相器の挿入損失を低減できる。

【 0 0 5 5 】

また、図 1 に示した移相器では、第 1 の制御信号線 4 の配線によっては、第 1 の制御信号線 4 から漏洩した電力が他のマイクロ波回路へ結合して、回路全体の特性に悪影響を及ぼしたり、共振の原因になるおそれがあった。しかし、第 1 の制御信号線 4 に第 1 の高周波信号阻止手段 6 を接続することにより、第 1 の制御信号線 4 から他のマイクロ波回路への電磁的結合を防止できるので、移相器が使用される回路の高周波特性を改善できる。

なお、図 8 に示した移相器の第 1 の制御信号線 4 に第 1 の高周波信号阻止手段 6 を接続しても、同様の効果が得られる。

【 0 0 5 6 】

次に、図 1 0 ～図 1 6 を用いて、図 9 における第 1 の高周波信号阻止手段 6 の構成例について説明する。

まず、第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 1 構成例について説明する。図 1 0 はこの第 1 構成例を示す図であり、図 1 0 (A) は回路図、図 1 0 (B) は平面図である。

第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 1 構成例は、高インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 1 と低インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 2 とにより構成されるフィルタ 3 0 である。

【 0 0 5 7 】

高インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 1 は、電気長が約 $\lambda / 4$ (λ は高周波信号 R F の波長) であり、主線路 1 よりも大きな特性インピーダンスを有している。また、低インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 2 は、電気長が約 $\lambda / 4$ であり、高インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 1 よりも小さな特性インピーダンスを有している。

これらの線路 3 1, 3 2 の特性インピーダンスの値は、例えば主線路 1 の特性が一般的な 50Ω であれば、高インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 1 の特性インピーダンスは概ね $70 \sim 200 \Omega$ 程度、低インピーダンス $\lambda / 4$ 線路 3 2 の特性インピ

ーダンスは概ね $20 \sim 40 \Omega$ 程度であることが望ましい。

【0058】

高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31 の一端は主線路 1 の一部である線路 1b に接続され、他端は低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 の一端に接続される。低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 の他端は開放されている。さらに、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31 の他端（すなわち、線路 31 と 32 の接続点 33）には、高インピーダンスの第 1 の制御信号線 4 が接続される。したがって、第 1 の制御信号線 4 は、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31 を介して、線路 1b に電氣的に接続される。

【0059】

以下、このフィルタ 30 の動作原理を簡単に説明する。

上述したように、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 の他端は開放されている。このため、この他端より $\lambda/4$ 経た接続点 33 から低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 側をみたときのインピーダンスは 0Ω となるので、接続点 33 で高周波的に接地されている状態と等価となる。したがって、この接続点 33 に第 1 の制御信号線 4 を並列に接続しても、接続点 33 でのインピーダンスは 0Ω のままであり、高周波の振る舞いに影響を与えない。

【0060】

さらに、線路 1b は接続点 33 から電気長が $\lambda/4$ の高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 を経て接続されているので、線路 1b からフィルタ 30 側をみたときのインピーダンスは無限大 ($\infty \Omega$) となる。したがって、線路 1b からフィルタ 30 側には高周波は流れないので、高周波的にはフィルタ 30 と第 1 の制御信号線 4 とがない状態と等価となる。

ここで説明したフィルタ 30 の構成は、一般にバイアスティーと呼ばれているが、特定の周波数帯のみ遮断するので、一種の帯域阻止フィルタとして動作する。

【0061】

次に、第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 2 構成例について説明する。図 11 はこの第 2 構成例を示す図であり、図 11 (A) は回路図、図 11 (B) は平面図

である。

第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 2 構成例は、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 と、キャパシタ 4 2 と、接地 4 3 とにより構成されるフィルタ 4 0 である。

図 1 1 (A) に示すように、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 の一端は主線路 1 の一部である線路 1 b に接続され、他端はキャパシタ 4 2 の一方の電極に接続される。また、このキャパシタ 4 2 の他方の電極は接地 4 3 に接続される。さらに、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 が接続されるキャパシタ 4 2 の一方の電極には、第 1 の制御信号線 4 が接続される。したがって、第 1 の制御信号線 4 は、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 を介して、線路 1 b に電氣的に接続される。

【0062】

キャパシタ 4 2 は図 1 1 (B) に示すように、前記一方の電極となる電極 4 4 と、前記他方の電極となる接地された電極 4 3 a と、電極 4 4、4 3 a 間に介挿された絶縁膜 4 5 とにより構成できる。

高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 は、特性インピーダンスが高く、電気長が約 $\lambda/4$ (λ は高周波信号 R F の波長) である。高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 の特性インピーダンスの値は、図 1 0 における高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 3 1 と同様に決められる。

【0063】

以下、このフィルタ 4 0 の動作原理を簡単に説明する。

キャパシタ 4 2 は十分な容量を有しているので、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 とキャパシタ 4 2 との接続点は高周波的に接地されているのと等価となり、インピーダンスは 0Ω となる。したがって、図 1 0 の場合と同様、この接続点に第 1 の制御信号線 4 をさらに接続しても、高周波的には影響がない。

さらに、線路 1 b はキャパシタ 4 2 から電気長が $\lambda/4$ の高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 を経て接続されているので、線路 1 b からフィルタ 4 0 側をみたときのインピーダンスは無限大 ($\infty \Omega$)、つまり線路 1 b からフィルタ 4 0 側に高周波信号 R F が流れない状態となる。

ここで説明したフィルタ 4 0 もバイアスティーの一種であり、帯域阻止フィルタとして動作する。

【 0 0 6 4 】

次に、第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 3 構成例について説明する。図 1 2 はこの第 3 構成例を示す回路図である。また、図 1 3 および図 1 4 は、第 3 構成例の具体例を示す平面図である。

第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 3 構成例は、インダクタンス素子からなるフィルタ 5 0 である。例えば、図 1 3 に示すスパイラルインダクタ 5 1、および図 1 4 に示すミアンダラインインダクタ 5 2 などを使用できる。

これら誘導性の回路素子は、直流～低周波数では低インピーダンスであるが、高周波数では高インピーダンスを示すので、低域通過フィルタとして動作する。ただし、カットオフ周波数は、高周波信号 R F の周波数よりも低く設定される。

【 0 0 6 5 】

このような分布定数素子だけでなく、コイルなどの集中定数素子を外付けして利用してもよい。

なお、低域通過フィルタとしては、特性インピーダンスの異なる線路を多段縦続接続して構成したフィルタなど、他のタイプのフィルタも利用できる。

【 0 0 6 6 】

次に、第 1 の高周波信号阻止手段 6 の第 4 構成例について説明する。図 1 5 はこの第 4 構成例を示す図であり、図 1 5 (A) は回路図、図 1 5 (B) は平面図である。

図 1 5 (A) に示すように、第 1 の高周波信号阻止手段 6 として抵抗素子 6 1 を第 1 の制御信号線 4 に直列に挿入して、高周波信号 R F の流入を阻止することもできる。

【 0 0 6 7 】

抵抗素子 6 1 のインピーダンスの値は、主線路 1 の特性インピーダンスの 2 倍以上であればよいが、概ね 2 0 倍以上に設定されることが望ましい。すなわち、主線路 1 の特性が一般的な $50\ \Omega$ であれば、抵抗素子 6 1 のインピーダンスは概ね $1\ \text{k}\ \Omega$ 以上に決められる。

このように抵抗素子 6 1 のインピーダンスを決めれば、主線路 1 から制御信号線 4 側をみたインピーダンスが大きくなるので、第 1 の制御信号線 4 への高周波

信号 R F の漏洩を抑制できる。

この抵抗素子 61 の作成には、例えば真空蒸着法またはスパッタ法により薄膜抵抗素子を形成する方法、半導体 n 層または n^+ 層を流用する方法などを利用できる。

【0068】

第 1 の制御信号線 4 への高周波信号 R F の漏洩を防止するために図 10～図 14 に示したフィルタ 30, 40, 50 を追加するとマイクロマシンスイッチの全体寸法が大きくなるが、図 15 に示した抵抗素子 61 を利用することにより全体寸法を大きくすることなく上記の目的を達成できる。

なお、図 16 に示すように抵抗素子 61 を第 1 の制御信号線 4 に並列に接続（つまり、抵抗素子 61 の一端を第 1 の制御信号線 4 に接続すると共に、他端を開放）しても、共振の発生防止には有効である。

【0069】

（第 4 の実施の形態）

図 17 は、本発明による移相器の第 4 の実施の形態の構成を示す図であり、図 17 (A) は回路図、図 17 (B) は平面図である。この図において、図 1 と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図 17 に示した移相器は、図 1 に示した移相器のカンチレバー 11 a, 11 b を、スタブ 3 a, 3 b および第 4 の制御信号線 4 a を介して接地 5 a に接続したものである。

【0070】

このようにしてカンチレバー 11 a, 11 b を接地することにより、スタブ 2 a, 2 b への電圧印加開始時にはカンチレバー 11 a, 11 b に静電誘導により発生する電荷を素早く充電でき、また電圧印加停止時には蓄積された電荷を素早く放電できる。したがって、マイクロマシンスイッチのスイッチング動作が安定すると共に、スイッチング速度が速くなる。これにより、移相器の移相量の切り換えを確実に、しかも迅速に行える。

なお、図 8 に示した移相器の主線路 1 に第 4 の制御信号線 4 a を接続して接地しても、同様の効果を得られる。

【0071】

(第5の実施の形態)

図18は、本発明による移相器の第5の実施の形態の構成を示す回路図である。この図において、図9および図17と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図18に示した移相器は、図17に示した移相器の第1の制御信号線4に第1の高周波信号阻止手段6を接続すると共に、第4の制御信号線4aに第2の高周波信号阻止手段6aを接続したものである。ここで、第2の高周波信号阻止手段6aは、第1の高周波信号阻止手段6と同じく、高周波信号RFの通過を阻止するものである。

【0072】

このように、高周波信号RFの通過を阻止する第1、第2の高周波信号阻止手段6、6aが第1、第4の制御信号線4、4aにそれぞれ接続されているので、主線路1およびスタブ3a、3bから第1、第4の制御信号線4、4aを介して高周波信号RFが漏洩することを防止できる。これにより、移相器の挿入損失を低減できると共に、高周波特性を改善できる。

【0073】

第2の高周波信号阻止手段6aとしては、第1の高周波信号阻止手段6に使用されるフィルタ30、40、50および抵抗素子61を利用できる。

特に、第1、第2の高周波信号阻止手段6、6aを共にフィルタ40と同様の構成とすれば、第1、第2の高周波信号阻止手段6、6aの構成を簡略化できる。図19は、第1、第2の高周波信号阻止手段6、6aの両方をフィルタ40と同様の構成としたときの移相器の構成図であり、図19(A)は回路図、図19(B)は平面図である。

【0074】

この移相器は、図19(B)に示すように、図11(B)に示した移相器のスタブ3a、3bを高インピーダンス $\lambda/4$ 線路41aで接地電極43aに接続するだけで構成できる。

ここで、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路41aは、スタブ2aを電極44に接続

する高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 と同様の構成をしている。ただし、図 1 9 (B) で高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 4 1 a は 2 分岐を有する構成となっているが、この場合、スタブ 3 a との接続点から接地電極 4 1 a との接続点までの電気長が $\lambda/4$ となり、またスタブ 3 b との接続点から接地電極 4 1 a との接続点までの電気長が $\lambda/4$ となるように設計される。

【0075】

図 1 9 (A) において、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路（第 1 の高インピーダンス線路）4 1 と、キャパシタ 4 2 と、接地 4 3 とにより第 1 の高周波信号阻止手段 6 が構成される。また、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路（第 2 の高インピーダンス線路）4 1 a を接地 4 3 に接続することにより第 2 の高周波信号阻止手段 6 a が構成される。

このように第 1，第 2 の高周波信号阻止手段 6，6 a の間で構成部品を共用することにより、マイクロマシンスイッチを小型化できるので、移相器を全体として小型化できる。

なお、第 1，第 2 の高周波信号阻止手段 6，6 a は、共に同じ構成であっても、異なる構成であってもよい。

【0076】

（第 6 の実施の形態）

図 2 0 は、本発明による移相器の第 6 の実施の形態の構成を示す回路図である。この図において、図 1 と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図 2 0 に示した移相器は、図 1 に示した移相器のスタブ 3 a，3 b に第 4 の制御信号線 4 a を介して定電圧源 5 b を接続したものである。

【0077】

定電圧源 5 b の出力電圧は、制御装置 5 から出力される制御信号 S と逆の極性を有している。すなわち、制御信号 S が正電圧のオン／オフからなる場合、定電圧源 5 b からは負の定電圧が出力される。

ただし、カンチレバー 1 1 a，1 1 b は制御信号 S に基づいて動作しなければならないので、定電圧源 5 b の出力電圧はそれ単独ではカンチレバー 1 1 a，1

1 b が動作しない程度の電圧に設定される。図 1 で 40 V の制御信号 S で動作するように設計されたカンチレバー 11 a, 11 b に対しては、定電圧源 5 b の出力電圧を例えば -20 V 程度とする。

【0078】

カンチレバー 11 a, 11 b の下面には共に絶縁膜 14 が形成され、またスタブ 3 a, 3 b の先端部は共に開放されている。したがって、スタブ 3 a, 3 b に印加された定電圧の電圧値は保持される。なお、ここでは、スタブ 3 a, 3 b の開放された先端部が、後述する第 3 の絶縁手段の機能を果たしている。

【0079】

このように、スタブ 3 a, 3 b を介してカンチレバー 11 a, 11 b に予め所定の電圧をかけておけば、制御信号 S の電圧の大きさを小さくできる。上記の例では、制御信号 S として 20 V の ON/OFF 信号を線路 1 b に印加することにより、カンチレバー 11 a, 11 b を動作させることができる。

制御信号 S として大きい電圧を印加すると、サージが発生したり、電圧の高速変化に基づくノイズが顕著になる場合がある。しかし、図 20 に示したマイクロマシンスイッチでは、制御信号 S の電圧の大きさを小さくできるので、このような問題を解決できる。

【0080】

図 8 に示した移相器で同様の効果を得るためには、カンチレバー 11 a, 11 b のそれぞれに形成された絶縁膜 14 と共に定電圧の電圧値を保持するための第 3 の絶縁手段を特別に設ける必要がある。この第 3 の絶縁手段は、例えば、図 1 に示したキャパシタ 15 a, 15 b を主線路 1 の同じ位置に形成することによって構成できる。あるいは、主線路 1 に接続された他のマイクロ波回路に含まれる結合コンデンサなどを、第 3 の絶縁手段として利用してもよい。

【0081】

図 21 は、図 20 に示した移相器の変形例を示す回路図である。この図に示した移相器は、第 1, 第 4 の制御信号線 4, 4 a にそれぞれ第 1, 第 2 の高周波信号阻止手段 6, 6 a が接続されている。第 1, 第 2 の高周波信号阻止手段 6, 6 a は、高周波信号 RF の通過を阻止するものであり、図 18 に示した移相器と同

様に構成される。

第 1, 第 2 の高周波信号阻止手段 6, 6 a を接続することにより、移相器の挿入損失の増加や高周波特性の劣化といった問題は生じない。

【 0 0 8 2 】

(第 7 の実施の形態)

図 2 2 は、本発明による移相器の第 7 の実施の形態の構成を示す平面図である。この図において、図 1 と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

図 2 2 に示した移相器は、図 1 に示した移相器とは異なるタイプのローデッドライン形の移相器である。これら 2 つの移相器の構成上の相違点は、図 1 に示した移相器がスタブ 2 a, 2 b とスタブ 3 a, 3 b との接続／開放を切り換えるのに対して、図 2 2 に示した移相器はスタブ 2 a, 2 b と接地電極 3 c との接続／開放を切り換えるところにある。

【 0 0 8 3 】

スタブ 2 a, 2 b が接地電極 3 c に高周波的に接続／開放されると、主線路 1 からスタブ 2 a, 2 b 側をみたサセプタンスが変化する。

したがって、図 1 に示した移相器で説明したのと同じ理由から、制御信号 S をオン／オフしてスタブ 2 a, 2 b と接地電極 3 c との高周波接続を制御することにより、主線路 1 を伝搬する高周波信号 R F の移相量を切り換えることができる。

【 0 0 8 4 】

図 2 2 に示した移相器では、マイクロマシンスイッチのカンチレバー 1 1 a, 1 1 b はそれぞれ、スタブ 2 a, 2 b の先端部に固定設置されても、接地電極 3 c のスタブ 2 a, 2 b 側周縁部に固定設置されてもよい。ただし、前者の場合はカンチレバー 1 1 a, 1 1 b の先端部（アーム 1 3 の先端部）がそれぞれ接地電極 3 c のスタブ 2 a, 2 b 側周縁部と接離自在となっており、後者の場合はそれぞれスタブ 2 a, 2 b の先端部と接離自在となっている必要がある。

なお、本発明では、接地電極 3 c を電位が 0（ゼロ）の分布定数線路と定義して、前記第 2 の分布定数線路に含めることとする。

また、第1の制御信号線4に第1の高周波信号阻止手段6を接続してもよい。

【0085】

(第8の実施の形態)

以上では、本発明をローデッドライン形の移相器に適用した場合の諸形態を説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばスイッチドライン形および反射形等、他のタイプの移相器に適用することもできる。

ここでは、本発明をスイッチドライン形の移相器に適用した形態を説明する。図23は、本発明による移相器の第8の実施の形態の一構成例を示す平面図である。

図23に示すように、主線路(第1の分布定数線路)101には寸断箇所があり、この主線路101は寸断箇所を挟む2本の線路101a, 101bにより構成されている。

そして、これらの線路101a, 101bの両方とわずかな隙間をもって、2本の切換線路(第2の分布定数線路)106a, 106bが配置されている。これらの切換線路106a, 106bは、互いに異なる電気長を有している。

【0086】

線路101a, 101bと切換線路106a, 106bとの間の4カ所の隙間にはそれぞれカンチレバー111a~111dが配置されている。より具体的には、線路101aと切換線路106aとの隙間にはカンチレバー111aが配置され、線路101bと切換線路106aとの隙間にはカンチレバー111bが配置され、線路101aと切換線路106bとの隙間にはカンチレバー111cが配置され、線路101bと切換線路106bとの隙間にはカンチレバー111dが配置されている。

【0087】

これらのカンチレバー111a~111dは、図1に示したカンチレバー11aと同様の構成をしている。このうちカンチレバー111a, 111bはそれぞれ切換線路106aの両端に固定設置されており、カンチレバー111a, 111bの先端部(アーム13の先端部)はそれぞれ線路101a, 101bのそれぞれの端部と接離自在となっているものとする。ただし、カンチレバー111a

、111bがそれぞれ線路101a、101bの各端部に固定設置され、カンチレバー111a、111bの先端部（アーム13の先端部）がそれぞれ切換線路106aの両端と接離自在となっていてよい。カンチレバー111c、111dと、線路101a、101bおよび切換線路106a、106bとの関係も同様である。

【0088】

切換線路106aには、第2の制御信号線104aが接続されており、この第2の制御信号線104aを介して制御信号（第2の制御信号）Sが印加される。また、切換線路106bには、第3の制御信号線104bが接続されており、この第3の制御信号線104bを介して制御信号（第3の制御信号）S（バー）が印加される。第2、第3の制御信号線104a、104bにより第1の制御信号線が構成される。

制御信号S、S（バー）は相補な2信号であり、図23では、電圧Vccと0（ゼロ）の変化からなる信号である。ここで、0（ゼロ）電位は接地電位を示しており、電圧Vccは0（ゼロ）でない電圧を示している。

【0089】

一方、主線路101を構成する線路101a、101bにはそれぞれ制御信号線104c、104dが接続されている。線路101a、101bには、これらの制御信号104c、104dを介して、定バイアスが印加される。この定バイアスは、制御信号S、S（バー）の2状態の一方の電圧（この場合、Vccまたは0（ゼロ））であることが望ましい。図23では、定バイアスとして接地電位が与えられている。

なお、この定バイアスは、制御信号S、S（バー）の2状態の一方の電圧と厳密に等しくなくてもよく、制御信号S、S（バー）の状態変化によりカンチレバー111a～111dが確実に動作する範囲で許容される。

【0090】

また、図示しないが図1に示した移相器と同様に、各カンチレバー111a～111dの先端部下面には第1の絶縁手段として絶縁膜がそれぞれ形成されている。ただし、同じ切換線路106a（または106b）に対して設けられた2個

のカンチレバー 111a, 111b (または 111c, 111d) に対応する 2 個の絶縁膜のうち的一方は、第 2 の絶縁手段として機能する。切換線路 106a, 106b にそれぞれ印加された電圧値は、これらの絶縁手段によって保持される。

【0091】

次に、図 23 に示した移相器の動作を説明する。

切換線路 106a, 106b の両方に制御信号 S, S (バー) が印加されていないとき (0V のとき)、カンチレバー 111a ~ 111d の先端部はいずれも線路 101a, 101b の端部と離間しているので、切換線路 106a, 106b は線路 101a, 101b に高周波的に接続されていない。

【0092】

この状態で、第 2 の制御信号線 104a を介して切換線路 106a に電圧 Vcc が印加され、第 3 の制御信号線 104b を介して切換線路 106b に接地電位が与えられるものとする。

線路 101a, 101b には共に接地電位が与えられているので、カンチレバー 111a, 111b の先端部はそれぞれ、線路 101a, 101b の端部との間に生ずる静電力によって吸引され、線路 101a, 101b の端部と接触する。これにより、切換線路 106a は線路 101a, 101b に高周波的に接続され、主線路 101 の寸断箇所を短絡する。

一方、切換線路 106b は線路 101a, 101b と同電位なので、カンチレバー 111c, 111d の先端部は線路 101a, 101b の端部と接触せず、切換線路 106a, 106b は線路 101a, 101b に高周波的に接続されない。

【0093】

次に、第 2 の制御信号線 104a を介して切換線路 106a に接地電位が与えられ、第 3 の制御信号線 104b を介して切換線路 106b に電圧 Vcc が印加されるものとする。

切換線路 106a への電圧 Vcc の印加が停止されると、カンチレバー 111a, 111b の先端部と線路 101a, 101b の端部との間の静電力がなくなる

。このため、カンチレバー 111a, 111b は元の形状に戻るので、切換線路 106a と線路 101a, 101b との高周波接続は開放される。

一方、カンチレバー 111c, 111d の先端部はそれぞれ、線路 101a, 101b の端部との間に生ずる静電力によって吸引され、線路 101a, 101b の端部と接触する。これにより、切換線路 106b は、切換線路 106a に代わって、主線路 101 の寸断箇所を高周波的に短絡する。

【0094】

このように、制御信号 S, S (バー) により、主線路 101 の寸断箇所を短絡する切換線路 106a, 106b を切り換えることができる。前述したように、切換線路 106a, 106b は互いに電気長が異なっているので、主線路 101 の寸断箇所を短絡する切換線路 106a, 106b を切り換えることにより、線路 101a と線路 101b との間の実効的な電気長を変化させることができる。したがって、主線路 101 を伝搬する高周波信号 RF の移相量を切り換えることができる。

【0095】

図 24 は、本発明による移相器の第 8 の実施の形態の他の構成例を示す平面図である。

図 24 に示した移相器では、切換線路 106a, 106b には定バイアスが印加され、主線路 101 を構成する線路 101a, 101b に制御信号 S が印加されており、この点で図 23 に示した移相器と相違する。

【0096】

すなわち、図 24 に示すように、線路 101a, 101b にはそれぞれ第 1 の制御信号線 104e, 104f が接続されており、これら第 1 の制御信号線 104e, 104f を介して制御信号 (第 1 の制御信号) S が印加される。制御信号 S は、電圧 Vcc と 0 (ゼロ) の変化からなる信号である。

【0097】

切換線路 106a には制御信号線 104g が接続されており、この制御信号線 104g を介して電圧 Vcc が印加されている。また、切換線路 106b には制御信号線 104h が接続されており、この制御信号線 104h を介して接地電位が

与えられている。

このように、切換線路 106 a, 106 b にそれぞれ与えられる定バイアスは、制御信号 S の 2 状態の各電圧（この場合、Vcc または 0（ゼロ））であることが望ましい。しかし、これらの定バイアスは制御信号 S の 2 状態の各電圧値と同等の定電圧であればよく、制御信号 S の状態変化によりカンチレバー 111 a ~ 111 d が確実に動作する範囲で許容される。

【0098】

また、主線路 101 を構成する線路 101 a, 101 b はそれぞれ、キャパシタ 115 a, 115 b が形成されている。キャパシタ 115 a, 115 b は、図 1 に示したキャパシタ 15 a, 15 b と同様に形成される。これら 2 個のキャパシタ 115 a, 115 b により第 2 の絶縁手段が構成される。

前述した第 1 の制御信号線 104 e, 104 f はそれぞれ、線路 101 a, 101 b の端部とキャパシタ 115 a, 115 b との間に接続される。したがって、キャパシタ 115 a, 115 b とカンチレバー 111 a ~ 111 d 毎に設けられた絶縁膜（図示せず）とにより、第 1 の制御信号線 104 e, 104 f を介して印加された制御信号 S の電圧値は保持される。

【0099】

このようにして構成された移相器では、線路 101 a, 101 b に制御信号 S として電圧 Vcc が印加されたとき、切換線路 106 b が線路 101 a, 101 b に高周波的に接続され、制御信号 S として接地電位が印加されたとき、切換線路 106 a が線路 101 a, 101 b に高周波的に接続される。したがって、制御信号 S により主線路 101 の寸断箇所を短絡する切換線路 106 a, 106 b を切り換えられるので、これにより主線路 101 を伝搬する高周波信号 RF の移相量を切り換えられる。

【0100】

なお、図 23 および図 24 に示した移相器において、制御信号線 104 a, 104 b, 104 e, 104 f に第 1 の高周波信号阻止手段 6 を接続し、制御信号線 104 c, 104 d, 104 g, 104 h に第 2 の高周波信号阻止手段 6 を接続することにより、主線路 101 を伝搬する高周波信号 RF の漏洩を防止できる

【0101】

(第9の実施の形態)

以上、第1～第8の実施の形態で示した移相器により、1ビットのデジタル移相器を実現できる。互いに移相量の異なるこれらの移相器を縦続接続することにより、2ビット以上のデジタル移相器を構成できる。

図25は、2個の移相器を縦続接続したときの一構成例を示す平面図である。この図において、図10および図18と同一部分を同一符号をもって示し、適宜その説明を省略する。

【0102】

図25で縦続接続されている移相器19-1, 19-2は共に、図18に示した移相器の一構成例であり、第1, 第2の高周波信号阻止手段6, 6aとして図10に示したフィルタ30が適用されている。ただし、移相器19-1, 19-2の移相量はそれぞれ異なっている。

【0103】

フィルタ30を構成する低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32は比較的大面積を必要とする。

そこで、図25に示すように、第2の高周波信号阻止手段6aとしてのフィルタ30については、各移相器19-1, 19-2で1個の低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32aを共用する。これにより、フィルタ30により構成された第2の高周波信号阻止手段6aを小型化できる。

なお、31a-1, 31a-2はそれぞれ、移相器19-1, 19-2の高インピーダンス $\lambda/4$ 線路である。

【0104】

また、第1の高周波信号阻止手段6としてのフィルタ30については、移相器19-1の低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32-1および移相器19-2の低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32-2を多層化し、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32-1, 32-2の間に SiO_2 などの絶縁膜35を介挿する。これにより、2個の低インピーダンス $\lambda/4$ 線路32-1, 32-2の占める面積を小さくできる。

また、各低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32-1, 32-2 は直流ないし低周波的に絶縁されているので、移相器 19-1, 19-2 にそれぞれ与えられる制御信号 S1, S2 が混信することはない。

【0105】

図 25 に示した移相器を製造する場合、図 6 および図 7 を参照すると、線路 1b およびスタブ 2a, 2b, 3a, 3b 等を製造する工程（図 6 (C)）で移相器 19-1 の高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31-1、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32-1 および第 1 の制御信号線 4-1 を同時に製造でき、絶縁膜 14, 16a, 16b を製造する工程（図 7 (B)）で絶縁膜 35 を同時に製造でき、線路 1a, 1c およびカンチレバー 11a, 11b を製造する工程（図 7 (C)）で移相器 19-2 の高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31-2、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32-2 および第 1 の制御信号線 4-2 を同時に製造できる。このように、図 1 に示した移相器と同じ工程数で、図 25 に示した移相器を製造できる。

【0106】

図 26 は、2 個の移相器を縦続接続したときの他の構成例を示す平面図である。図 26 で縦続接続されている移相器 19-3, 19-4 は共に、図 8 に示した移相器と同様に、スタブ 3a, 3b に制御信号 S1, S2 が印加される。このタイプの移相器でも、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32-1, 32-2 を多層化して、小型化を図ることができる。なお、31a は高インピーダンス $\lambda/4$ 線路である。

【0107】

（第 10 の実施の形態）

本発明による移相器は、他の配線と共に移相器を基板 10 上に形成してもよいし、移相器の構成の一部または全部をチップ化してこれを基板 10 に搭載・実装することによりマイクロ波回路（またはミリ波回路）を形成してもよい。

ここでチップ化とは、単位回路を半導体プロセスなどにより別基板上に多数一括形成して単位回路ごとに切り出し、さらに基板に搭載・実装するための加工を施すことをいう。

【0108】

図 27 は、移相器をチップ化したものを基板 10 に実装して図 10 に示した移相器を形成したときの平面図である。

図 27 (A) では、主線路 1 の一部である線路 1 b と、スタブ 2 a, 2 b, 3 a, 3 b と、カンチレバー 11 a, 11 b と、キャパシタ 15 a, 15 b とがチップ化され、チップ 71 が形成されている。

一方、予め基板 10 上には、主線路 1 の他の一部である線路 1 a, 1 c と、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31 と、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 と、第 1 の制御信号線 4 とが配線されている。

この基板 10 にチップ 71 を実装することにより、図 10 に示した移相器と同等の機能を実現できる。

【0109】

また、図 27 (B) では、スタブ 2 a, 3 a の端部 2 a a, 3 a a とカンチレバー 11 a とがチップ化されてチップ 72 a が形成され、スタブ 2 b, 3 b の端部 2 b b, 3 b b とカンチレバー 11 b とがチップ化されてチップ 72 b が形成されている。

一方、予め基板 10 上には、主線路 1 を構成する線路 1 a ~ 1 c と、スタブ 2 a, 2 b, 3 a, 3 b の端部 2 a a, 2 b b, 3 a a, 3 b b を除く部分と、高インピーダンス $\lambda/4$ 線路 31 と、低インピーダンス $\lambda/4$ 線路 32 と、第 1 の制御信号線 4 とが配線されている。

この基板 10 にチップ 72 a, 72 b と、キャパシタ 15 a, 15 b としてのチップコンデンサ 73 a, 73 b とを実装することにより、図 10 に示した移相器と同等の機能を実現できる。

【0110】

図 27 (A), (B) に示したように移相器をチップ化することにより、チップ 71, 72 a, 72 b 単体の不良検査を実施できるので、移相器が使用される回路全体の歩留まりを向上できるという利点がある。

【0111】

(第 11 の実施の形態)

図 1 に示した移相器では、スタブ 2 a とスタブ 3 a とを容量結合する第 1 の絶

縁手段として、アーム 13 の先端部下面とスタブ 2 a の端部上面との間に介在する絶縁膜 14, 14 a が用いられる。しかし、第 1 の絶縁手段は、これらの絶縁膜 14, 14 a を用いなくても構成できる。

図 28 は、第 1 の絶縁手段の他の構成例を示す平面図である。また、図 29 は、オフ時の第 1 の絶縁手段の断面図であり、図 29 (A) は図 28 における A-A' 線方向の断面図、図 29 (B) は図 28 における B-B' 線方向の断面図である。また、図 30 は、オン時の第 1 の絶縁手段の断面図であり、図 30 (A) は図 28 における A-A' 線方向の断面図、図 30 (B) は図 28 における B-B' 線方向の断面図である。

【0112】

図 28 に示すように、スタブ 2 a の端部の両側に、このスタブ 2 a と離間して、突起部 84 a, 84 b がそれぞれ配置されている。突起部 84 a, 84 b は図 29 に示すように、スタブ 2 a の厚みよりも僅かに厚く（高く）形成されている。突起部 84 a, 84 b は、誘電体、半導体、導体のいずれで形成されてもよい。

一方、スタブ 3 a の端部上にはポスト 82 が形成されており、このポスト 82 の上面にはアーム 83 の基部が固定されている。このアーム 83 は、ポスト 82 の上面から隙間を跨いで、スタブ 2 a の端部の上方まで延在している。ただし、アーム 83 は基部よりも先端部の方が幅広となっており、図 28 に示すようにアーム 83 の先端部は突起部 84 a, 84 b の両方と対向している。

【0113】

このような構成において、スタブ 2 a とアーム 83 との間に制御信号 S に基づく吸引力が発生すると、この力によりアーム 83 の先端部はスタブ 2 a 側に引き寄せられる。しかし、突起部 84 a, 84 b がストッパとして機能し、図 30 に示すようにアーム 83 の変位は突起部 84 a, 84 b の上面で停止する。

このとき、スタブ 2 a とアーム 83 との間には薄い空気層 84 が形成される。この空気層 84 が介在することによりスタブ 2 a とアーム 83 とは直流ないし低周波的に絶縁されるが、空気層 84 の厚みは十分薄いのでスタブ 2 a とアーム 83 とは高周波的に結合される。

【0 1 1 4】

以上、本発明による移相器の種々の形態を説明したが、この移相器は例えばフェーズドアレーアンテナなどに使用できる。

【0 1 1 5】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明による移相器では、マイクロマシンスイッチのカンチレバーを分布定数線路上に固定設置すると共に、分布定数線路に第 1 の制御信号を直接印加してこの分布定数線路をマイクロマシンスイッチの制御電極として作用させる。これにより、従来のマイクロマシンスイッチで必要であったボスト、アーム、および上部・下部電極が不要となるので、マイクロマシンスイッチを小型化できる。したがって、スイッチング素子としてマイクロマシンスイッチを使用する移相器を全体として小型化できる。また、マイクロマシンスイッチの構造が簡単であるので、少ない工程で移相器を製造できる。

【0 1 1 6】

また、高周波信号の通過を阻止する第 1 の高周波信号阻止手段を第 1 の制御信号線に接続することにより、第 1 の制御信号線への高周波信号の漏洩を防止できる。したがって、マイクロマシンスイッチの挿入損失を低減できる。また、第 1 の制御信号線から他の線路への電磁的結合を防止できるので、移相器が使用される回路の高周波特性を改善できる。

【0 1 1 7】

また、移相器に含まれる第 1 および第 2 の分布定数線路のうち、第 1 の制御信号が印加されない方の分布定数線路に第 4 の制御信号線を接続し、この第 4 の制御信号線を介して静電誘導に基づく電荷の充放電を行う。これにより、マイクロマシンスイッチのスイッチング動作が安定すると共にスイッチング速度が速くなるので、移相器の移相量の切り換えを確実にしかも迅速に行うことができる。

また、第 1 の制御信号が印加されない方の分布定数線路に第 4 の制御信号線を接続し、第 1 の制御信号とは逆の極性の電圧をかけておくことにより、第 1 の制御信号の電圧の大きさを小さくできるので、サージおよびノイズの発生を抑制できる。

【0 1 1 8】

これらの場合、高周波信号の通過を阻止する第 2 の高周波信号阻止手段を第 4 の制御信号線に接続することにより、第 4 の制御信号線への高周波信号の漏洩を防止できる。したがって、挿入損失の増加や高周波特性の劣化といった問題は生じない。

また、第 1 および第 2 の高周波信号阻止手段を共にキャパシタを用いたバイアスティーで構成する場合、構成部品を共用することにより、構成を簡略化できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明による移相器の第 1 の実施の形態の構成図である。

【図 2】 図 1 に示した移相器の断面図である。

【図 3】 図 1 に示した移相器の変形例を示す回路図である。

【図 4】 第 1 の絶縁手段の変形例を示す断面図である。

【図 5】 カンチレバーの変形例を示す断面図である。

【図 6】 図 1 に示した移相器を製造する際の主要な工程を示す断面図である。

【図 7】 図 6 に引き続く工程を示す断面図である。

【図 8】 本発明による移相器の第 2 の実施の形態の構成図である。

【図 9】 本発明による移相器の第 3 の実施の形態の構成を示す回路図である。

【図 1 0】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 1 構成例を示す図である。

【図 1 1】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 2 構成例を示す図である。

【図 1 2】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 3 構成例を示す回路図である。

【図 1 3】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 3 構成例の具体例を示す平面図である。

【図 1 4】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 3 構成例の具体例を示す平面図である。

【図 1 5】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 4 構成例を示す図である。

【図 1 6】 第 1 の高周波信号阻止手段の第 4 構成例の変形例を示す図であ

る。

【図 1 7】 本発明によるマイクロマシンスイッチの第 4 の実施の形態の構成図である。

【図 1 8】 本発明による移相器の第 5 の実施の形態の構成を示す回路図である。

【図 1 9】 第 1, 第 2 の高周波信号阻止手段の両方をフィルタ 4 0 と同様の構成としたときの移相器の構成図である。

【図 2 0】 本発明による移相器の第 6 の実施の形態の構成を示す回路図である。

【図 2 1】 図 2 0 に示した移相器の変形例を示す回路図である。

【図 2 2】 本発明による移相器の第 7 の実施の形態の構成を示す平面図である。

【図 2 3】 本発明による移相器の第 8 の実施の形態の一構成例を示す平面図である。

【図 2 4】 本発明による移相器の第 8 の実施の形態の他の構成例を示す平面図である。

【図 2 5】 2 個の移相器を縦続接続したときの一構成例を示す平面図である。

【図 2 6】 2 個の移相器を縦続接続したときの他の構成例を示す平面図である。

【図 2 7】 移相器をチップ化したものを基板に実装して図 1 0 に示した移相器を形成したときの平面図である。

【図 2 8】 第 1 の絶縁手段の他の構成例を示す平面図である。

【図 2 9】 図 2 8 に示した第 1 の絶縁手段のオフ時の断面図である。

【図 3 0】 図 2 8 に示した第 1 の絶縁手段のオン時の断面図である。

【図 3 1】 公知の移相器に従来のマイクロマシンスイッチを使用した場合の平面図である。

【図 3 2】 図 3 1 に示した従来のマイクロマシンスイッチを拡大して示す平面図である。

【図 3 3】 図 3 1 に示した従来のマイクロマシンスイッチの断面図である。

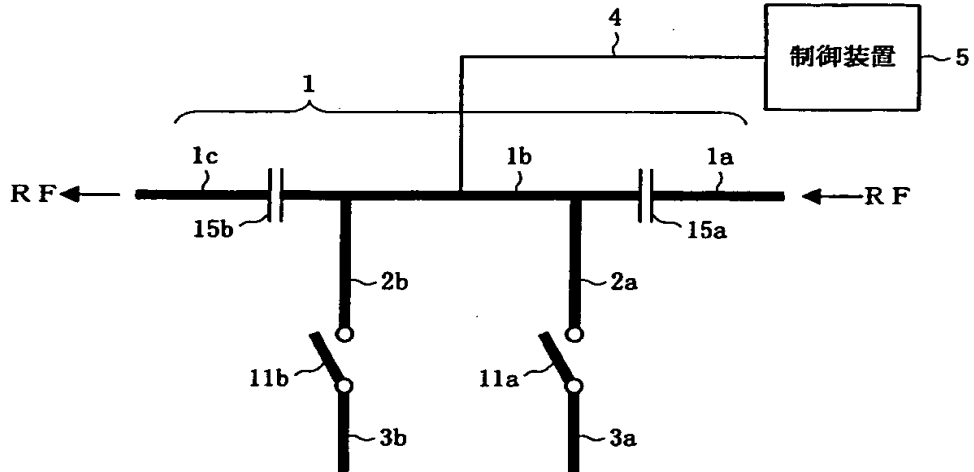
【符号の説明】

1, 101…主線路、1a~1c, 101a, 101b…線路、2a, 2b, 3a, 3b…スタブ、3c, 43a, 44…電極、4, 4a, 104a~104h…制御信号線、5…制御装置、5a, 43…接地、5b…定電圧源、6, 6a…高周波信号阻止手段、10…基板、11a, 11b, 11a', 81, 111a~111d…カンチレバー、12, 12', 82…ポスト、13, 13', 83…アーム、14, 14a, 14', 16a, 16b, 24, 35, 45, 116a, 116b…絶縁膜、15a, 15b, 42, 115a, 115b…キャパシタ、19-1~19-4…移相器、21…レジストパターン、21a…溝、22…金属膜、23…犠牲層、30, 40, 50…フィルタ、31, 31a, 41, 41a…高インピーダンスλ/4線路、32, 32a, 32-1, 32-2…低インピーダンスλ/4線路、33…接続点、51…スパイラルインダクタ、52…ミアンダラインインダクタ、61…抵抗素子、71, 72a, 72b…チップ、73a, 73b…チップコンデンサ、84…空気層、84a, 84b…突起部、91…マイクロ波回路、106a, 106b…切換線路。

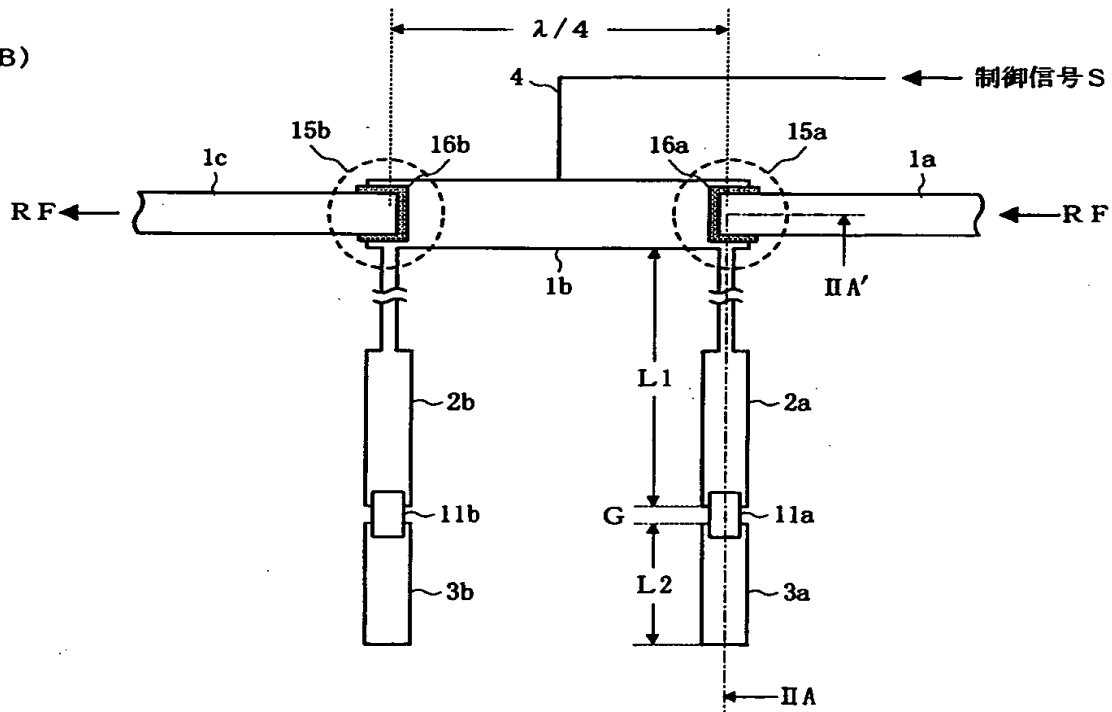
【書類名】 図面

【図 1】

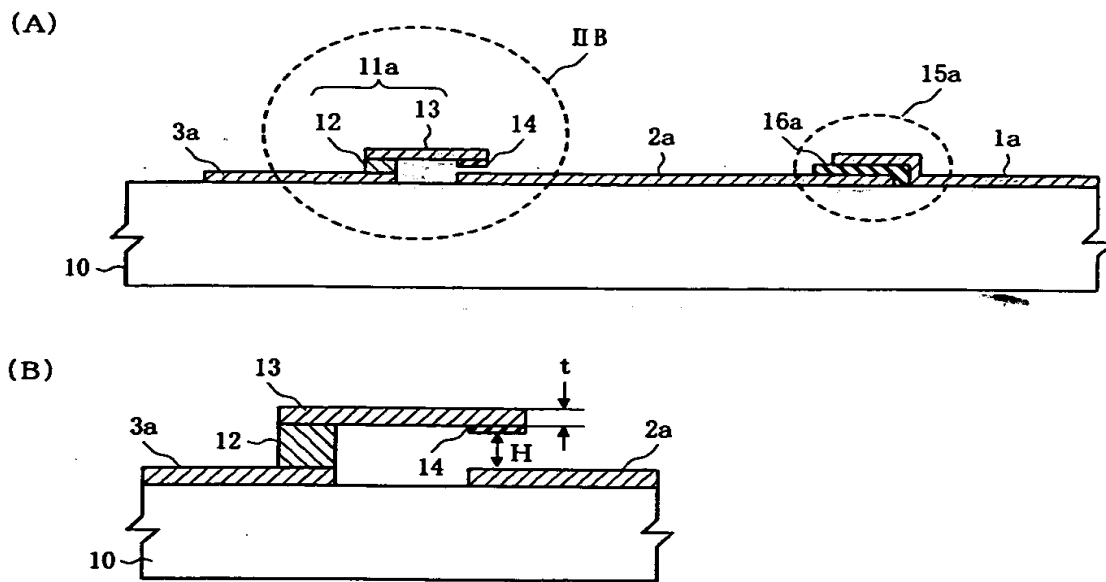
(A)



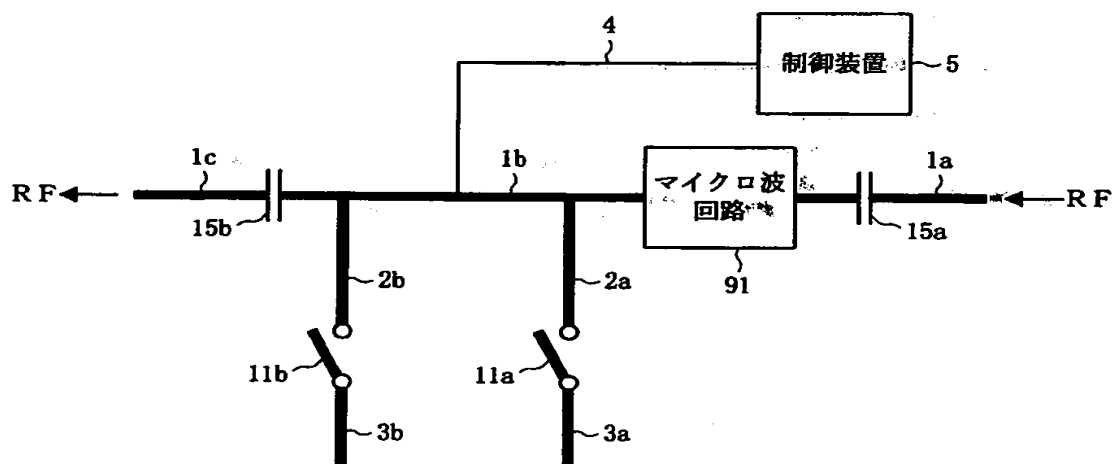
(B)



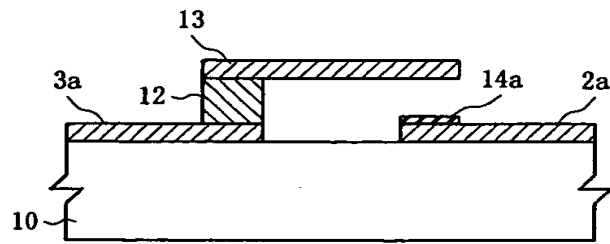
【図 2】



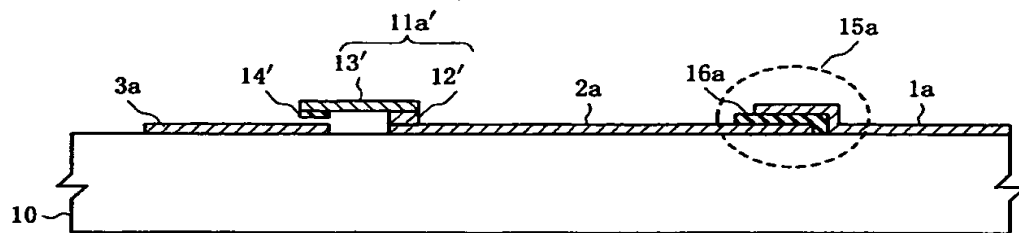
【図 3】



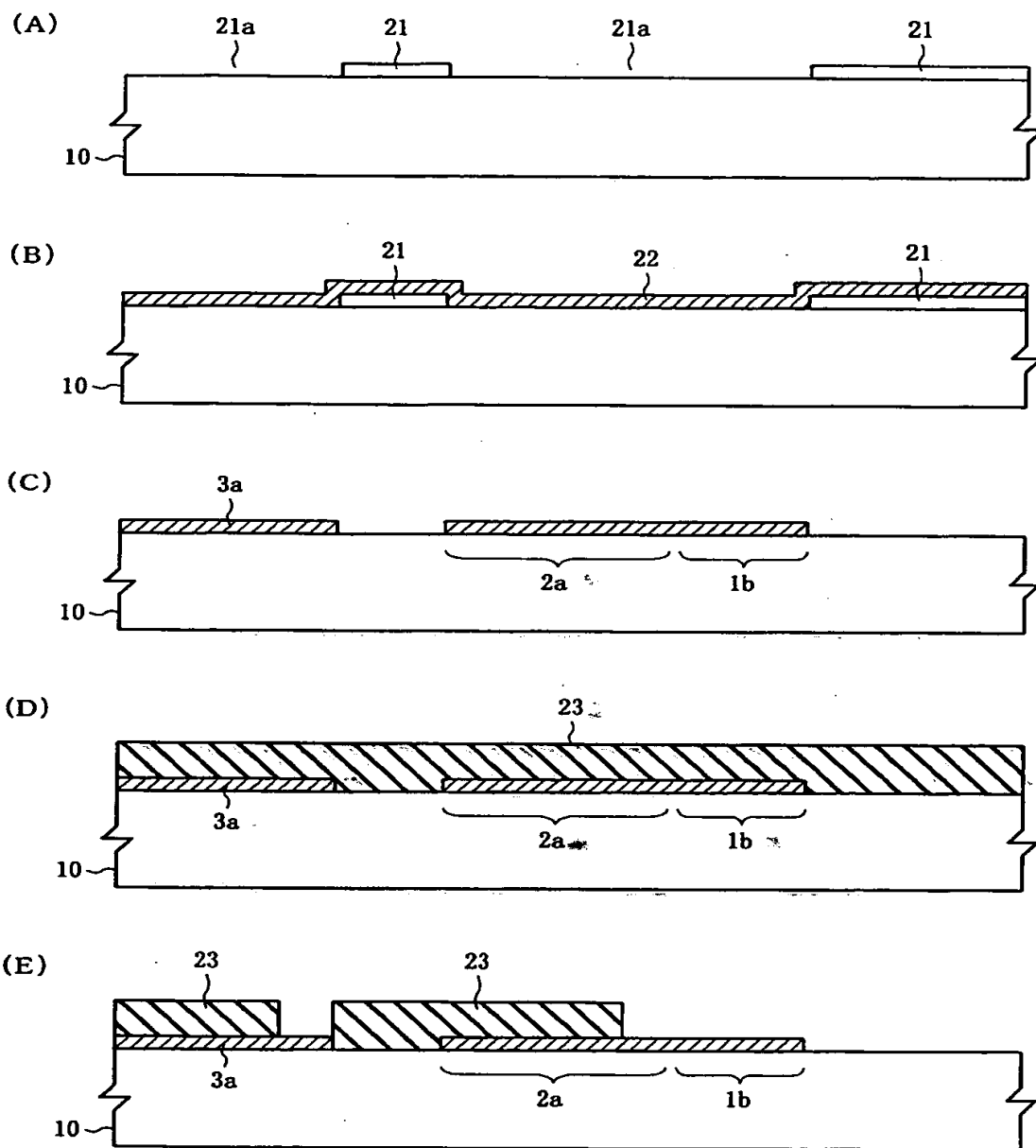
【図 4】



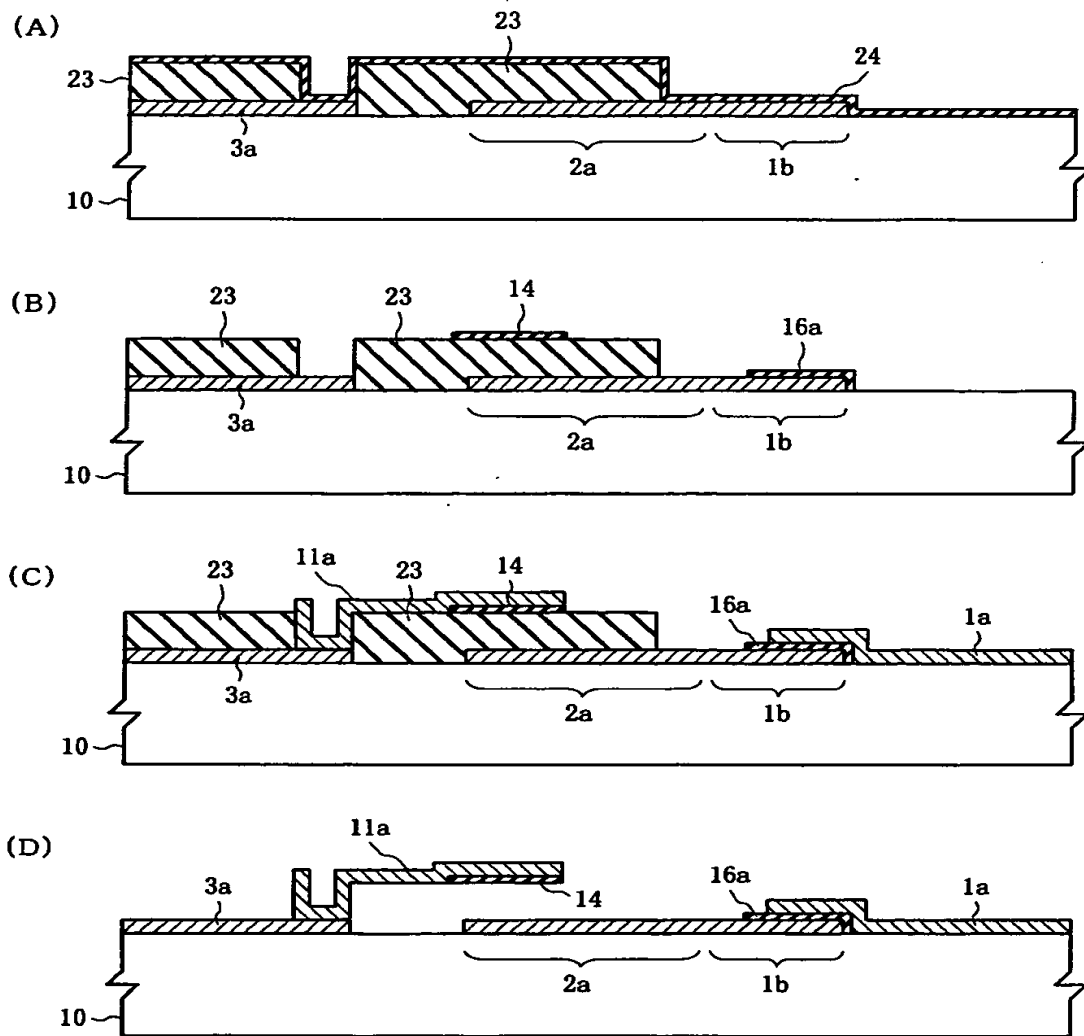
【図 5】



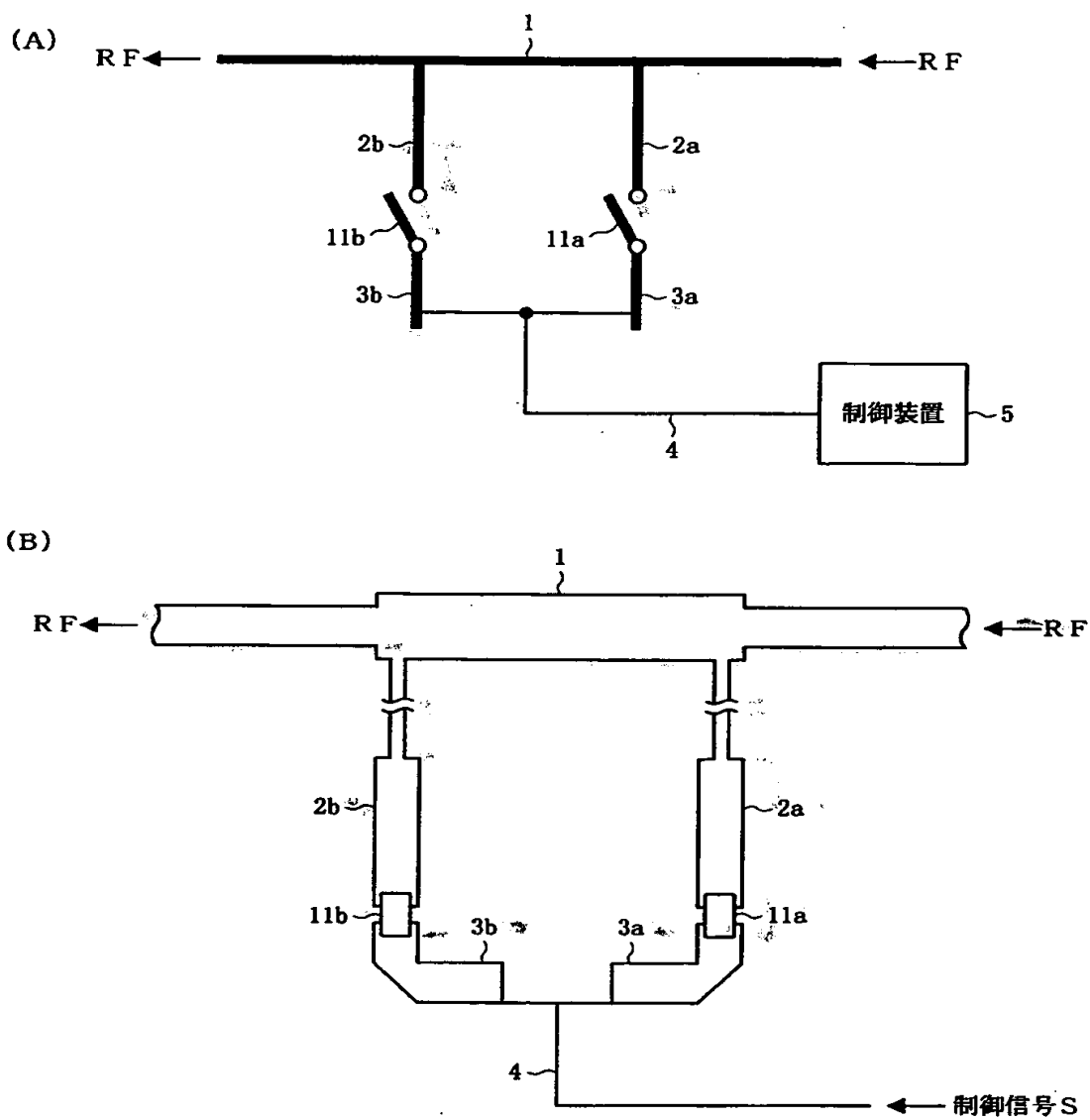
【図 6】



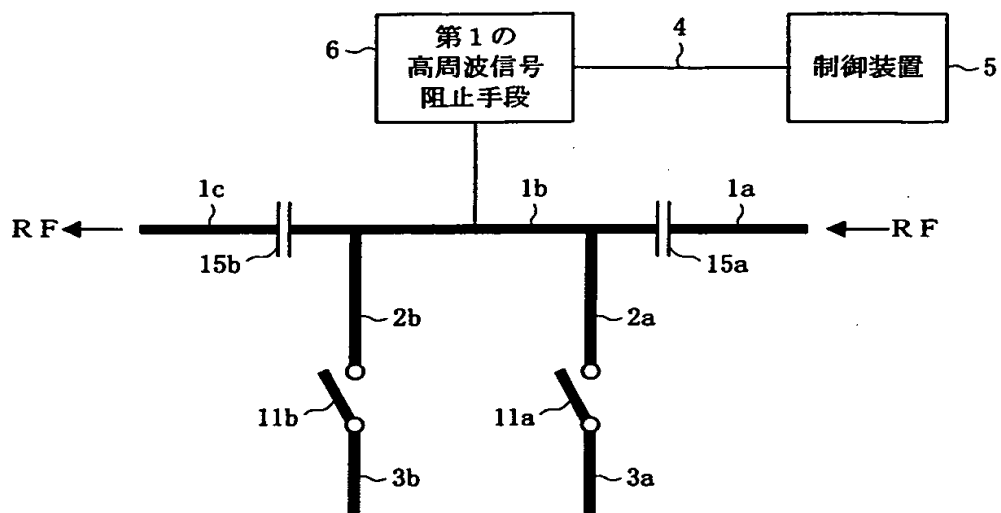
【図 7】



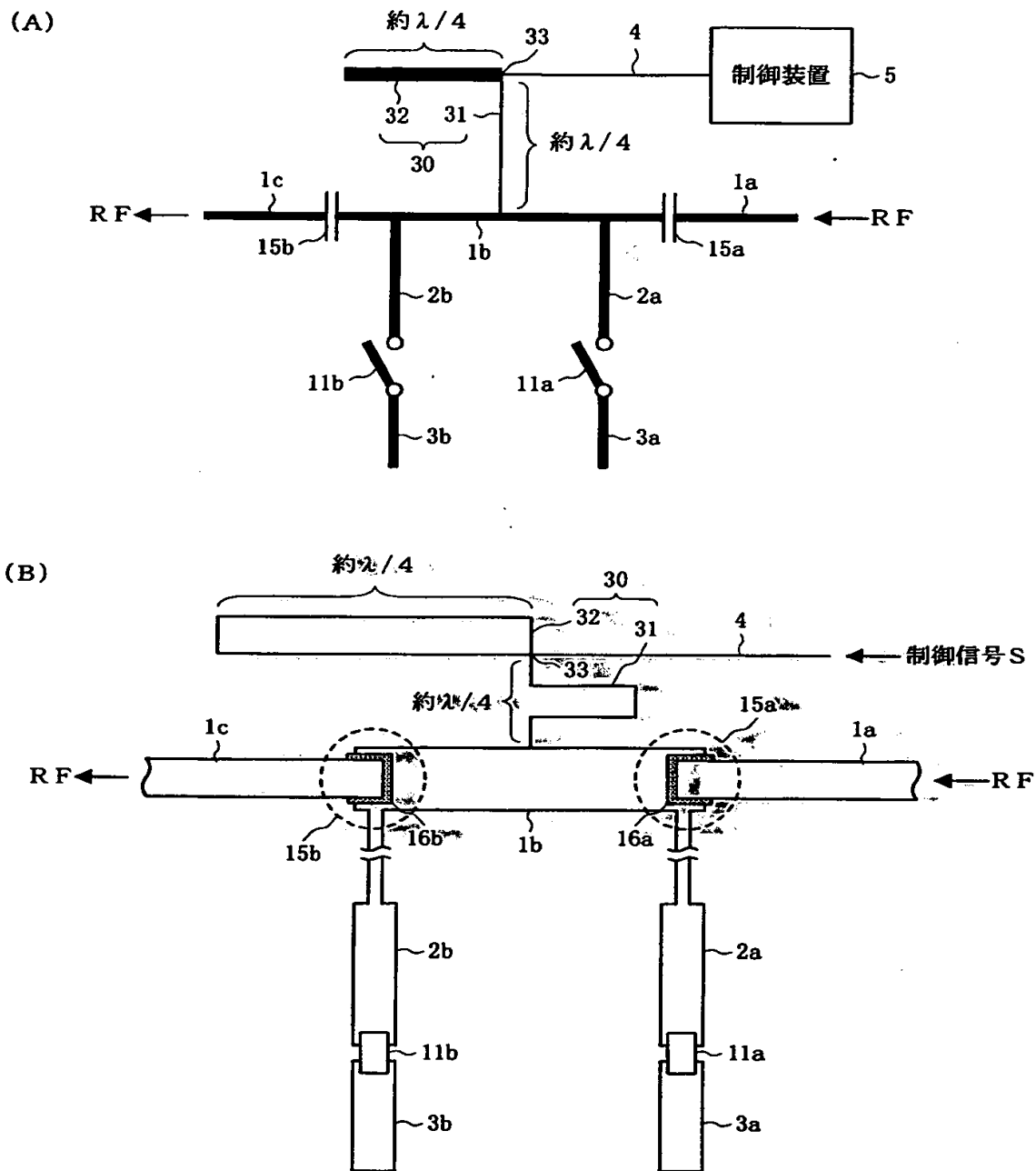
【図 8】



【図 9】

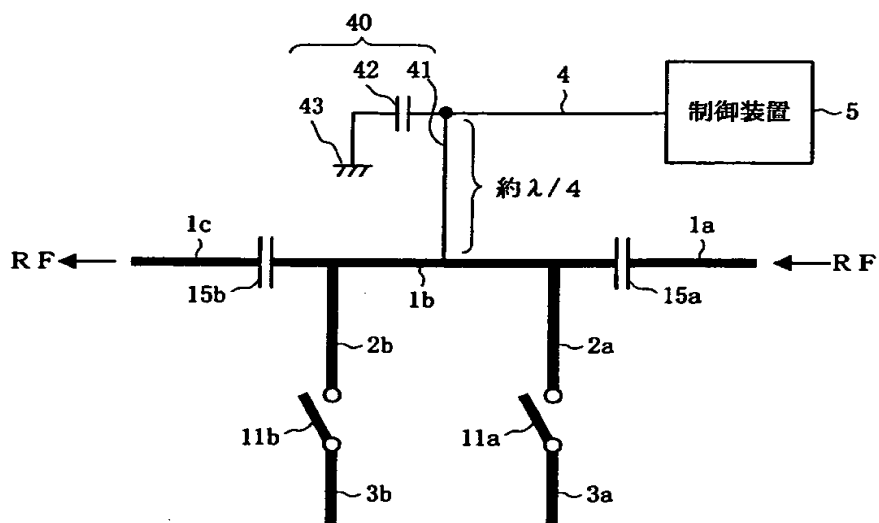


【図 10】

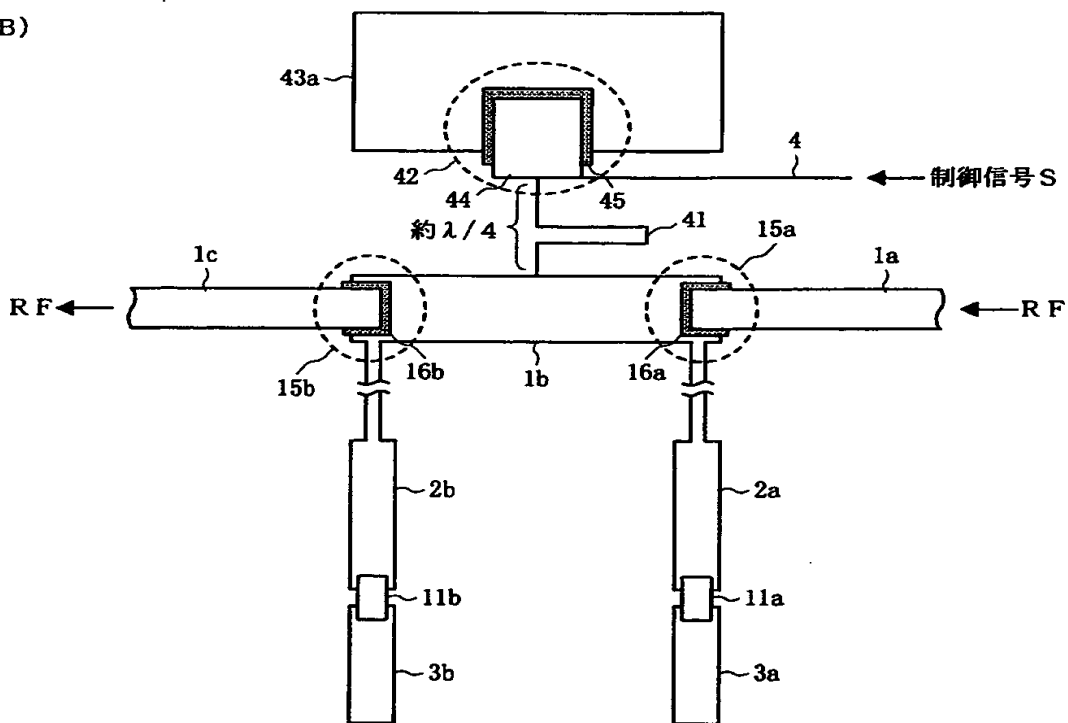


【図 11】

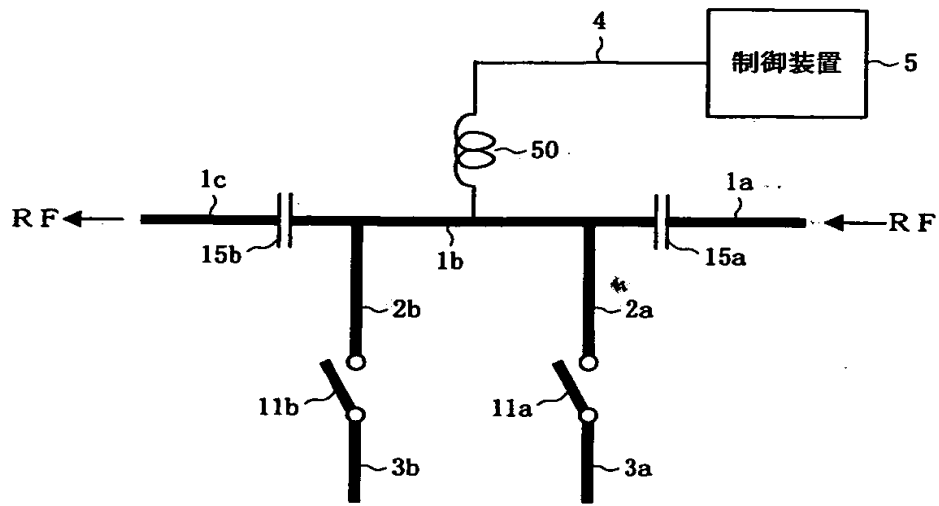
(A)



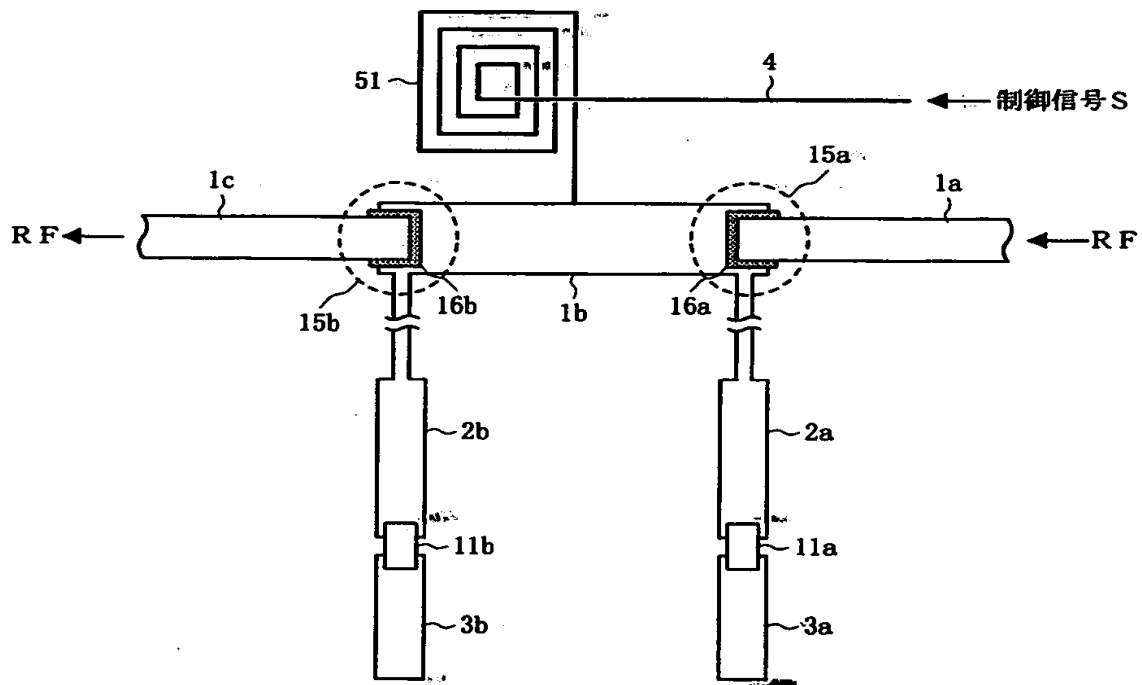
(B)



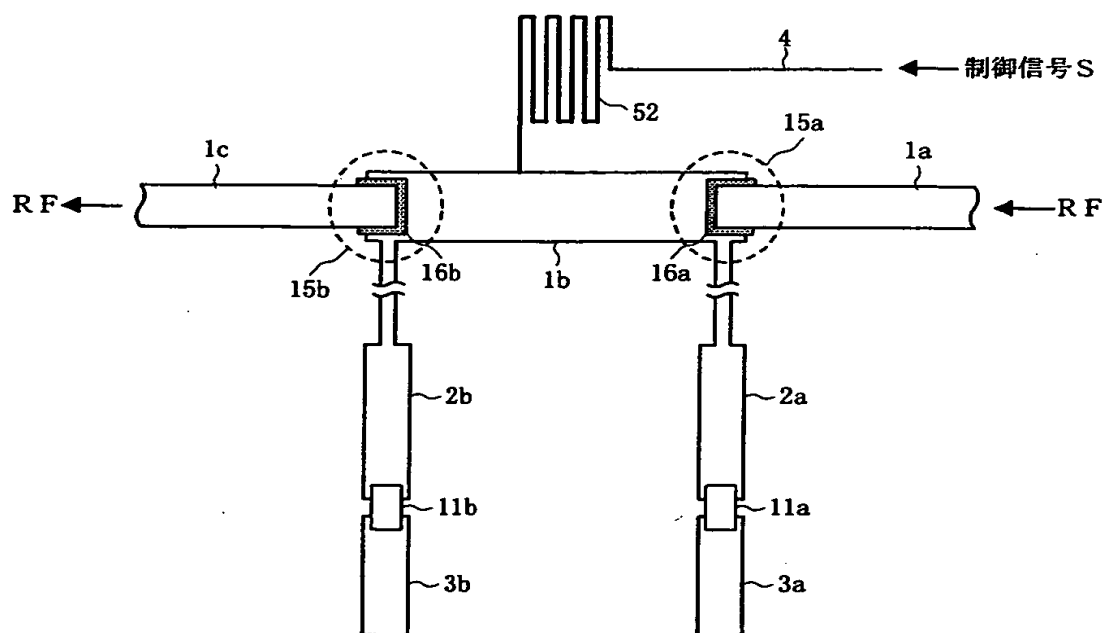
【図 1 2】



【図 1 3】

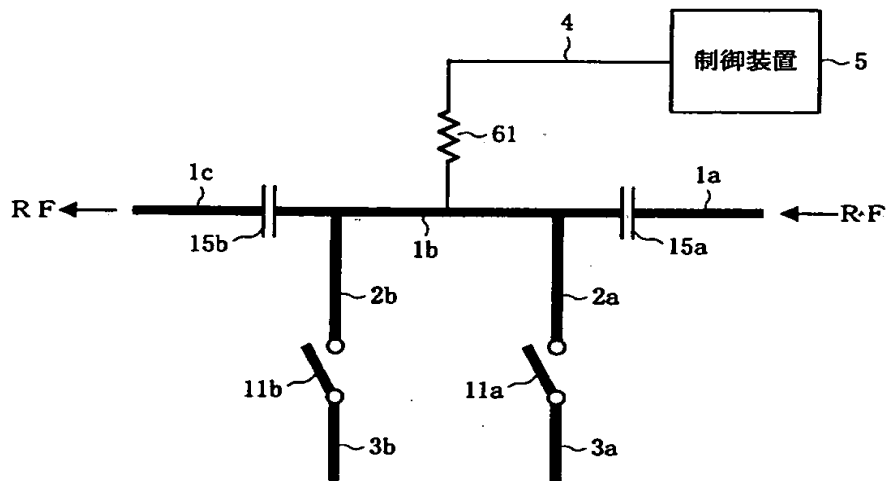


【図 1 4】

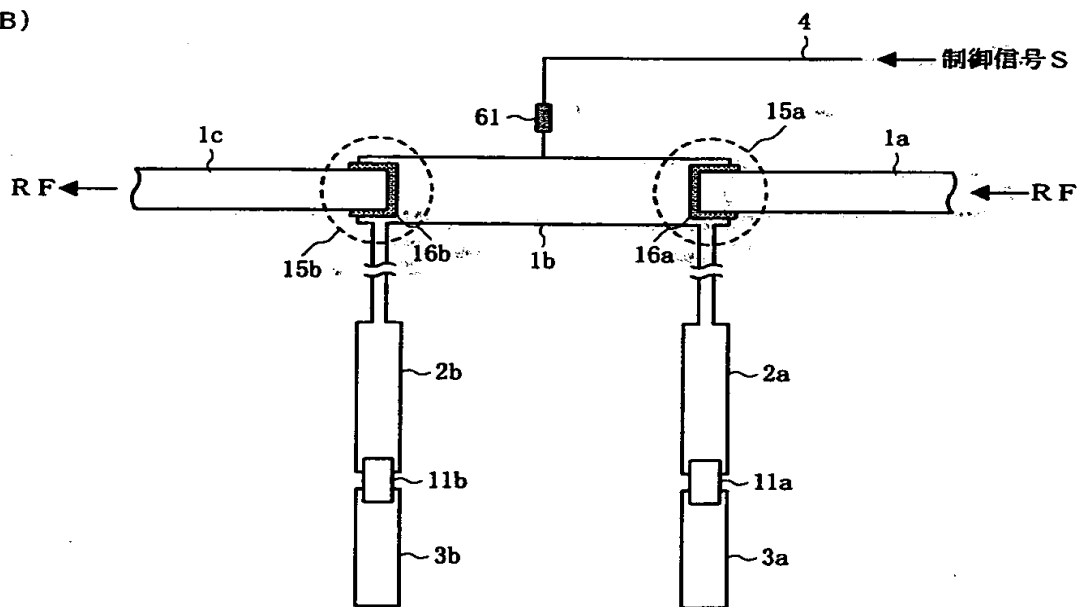


【図 15】

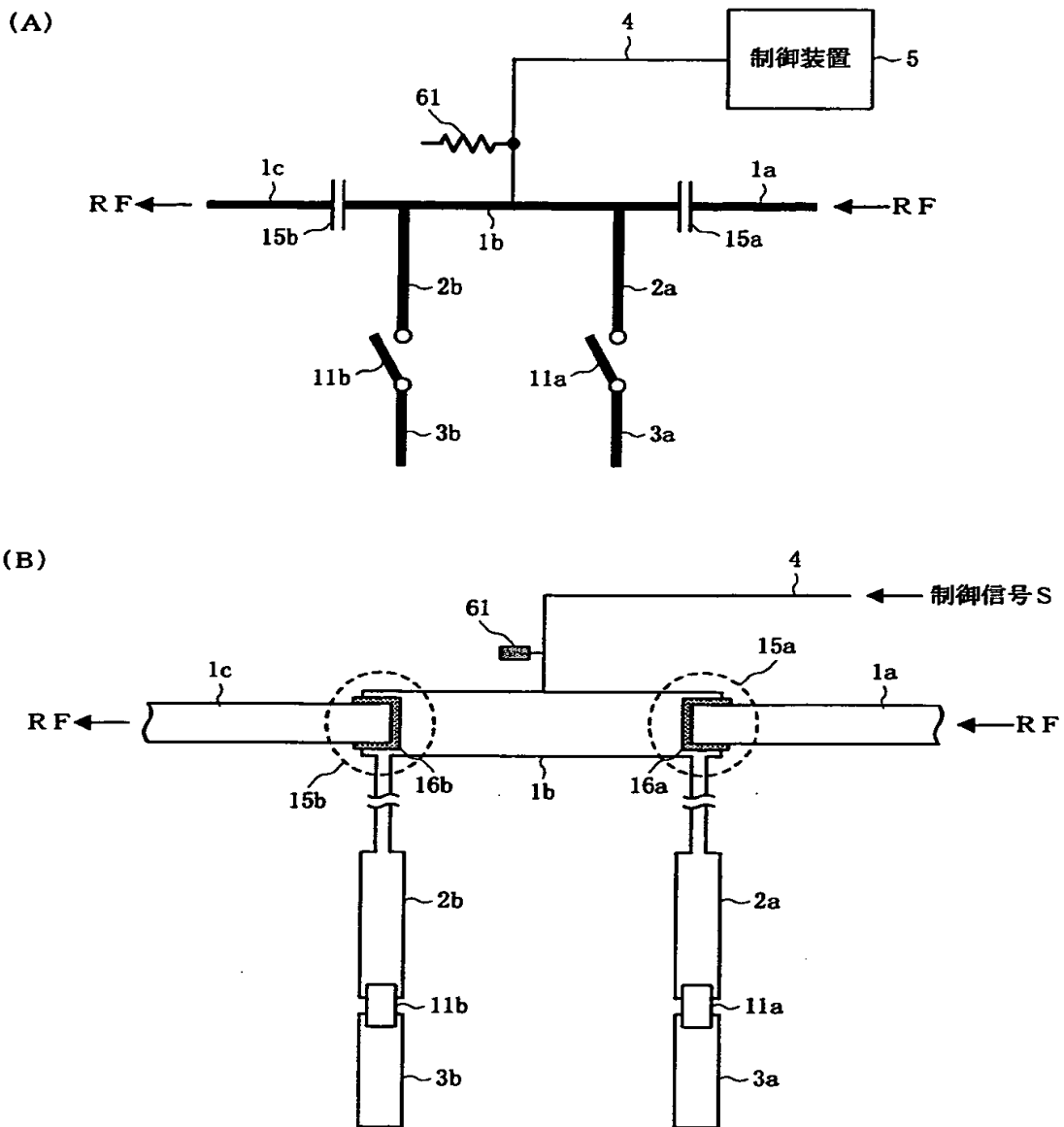
(A)



(B)

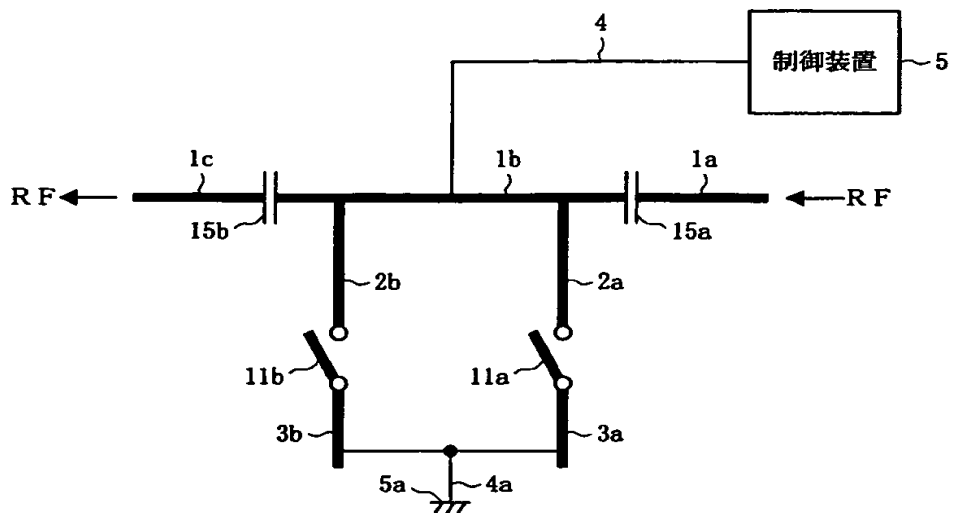


【図 1 6】

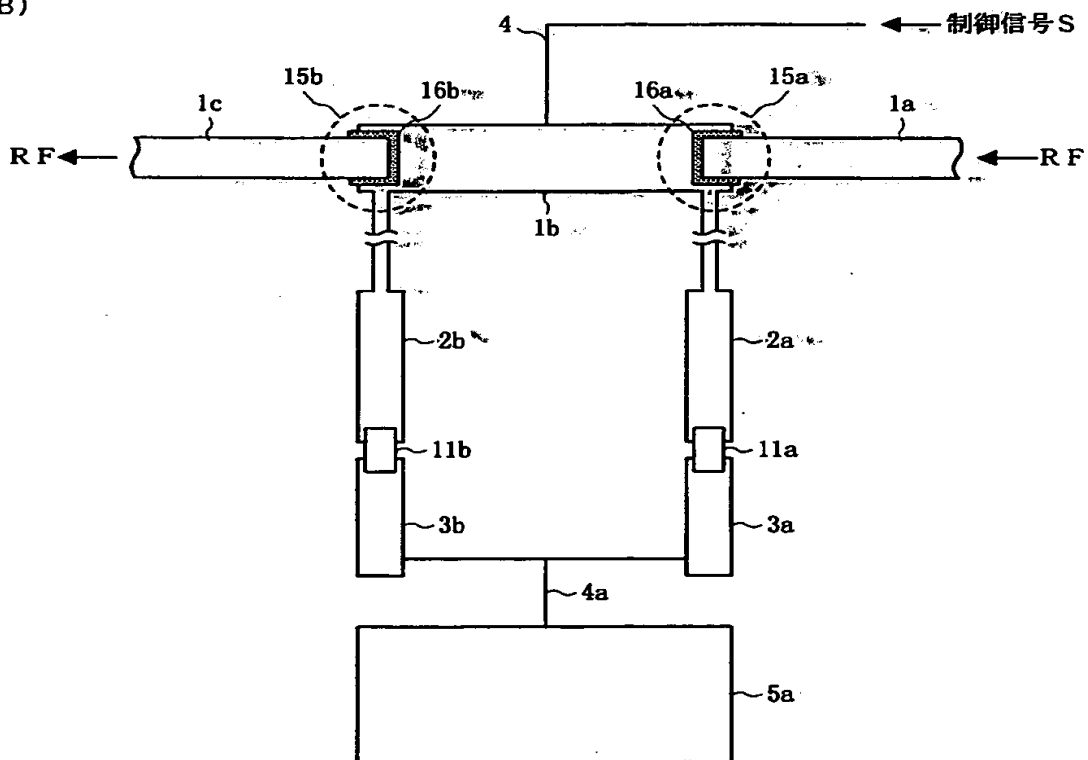


【図 1 7】

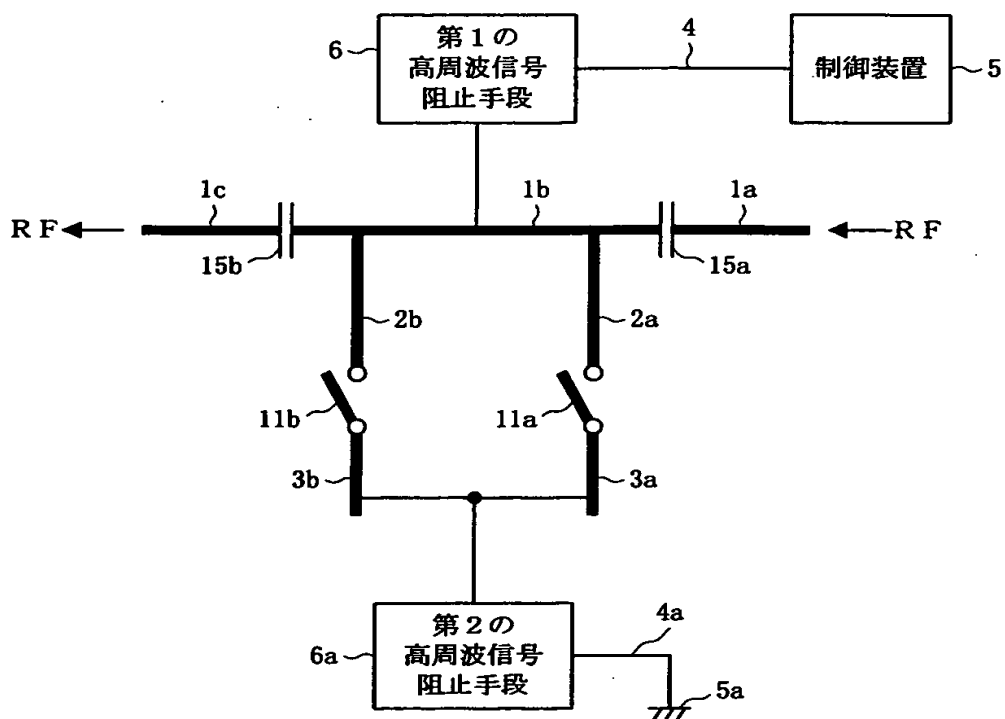
(A)



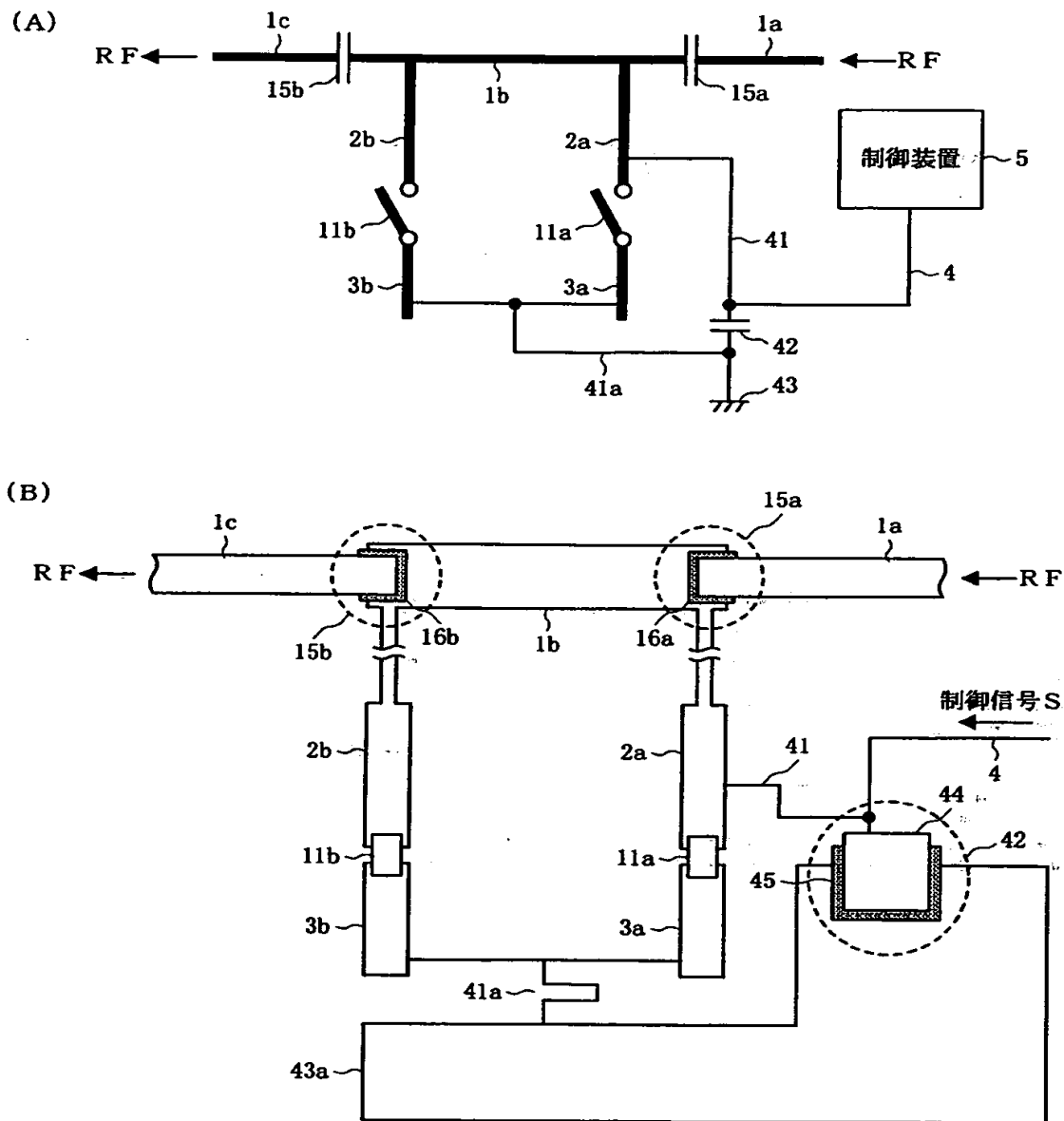
(B)



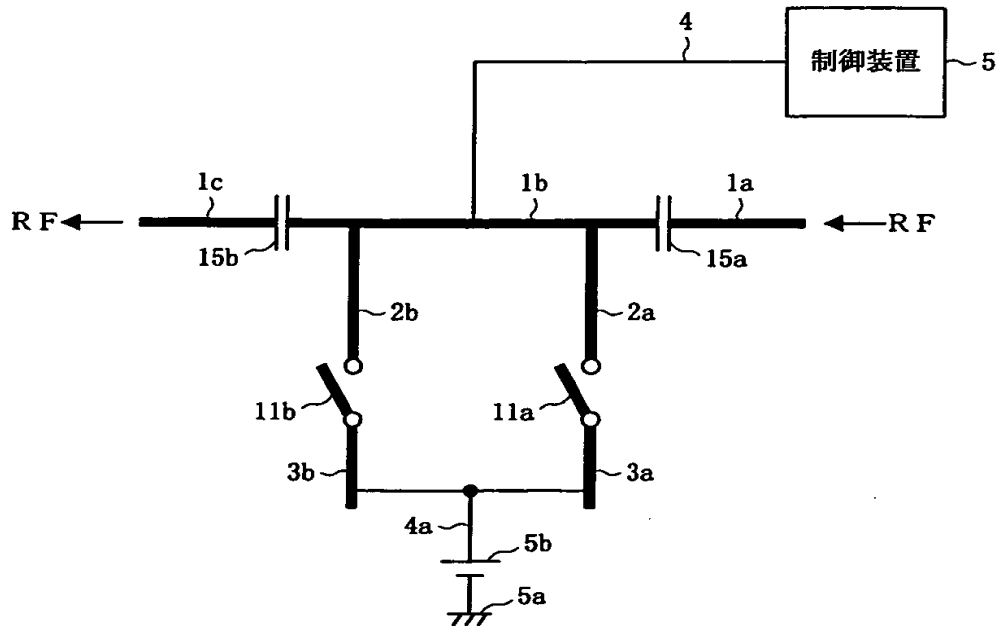
【図 1 8】



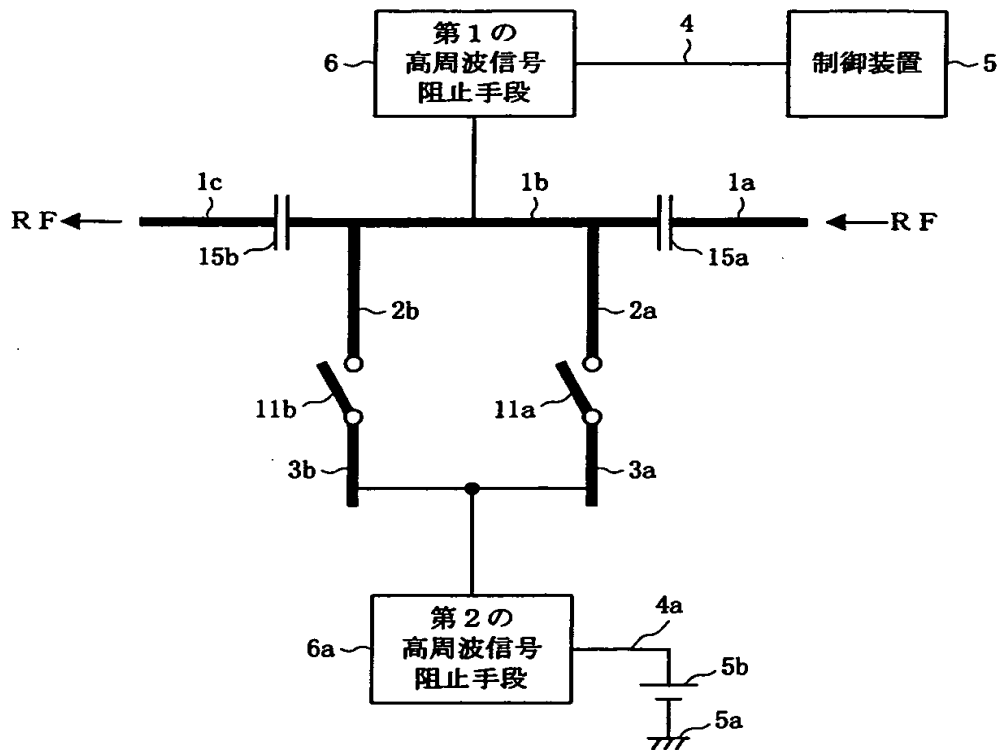
【図 1 9】



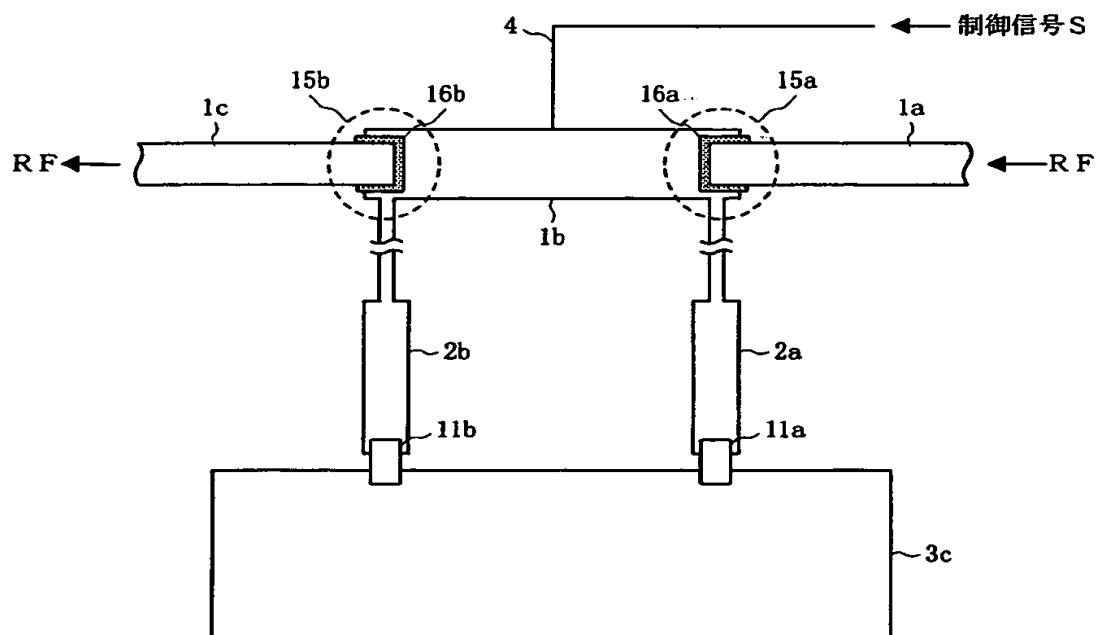
【図 2 0】



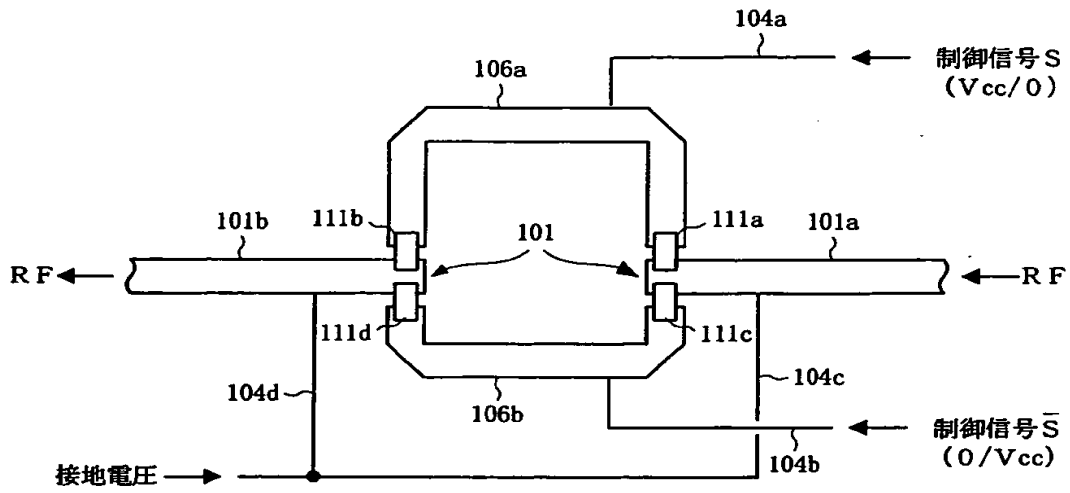
【図 2 1】



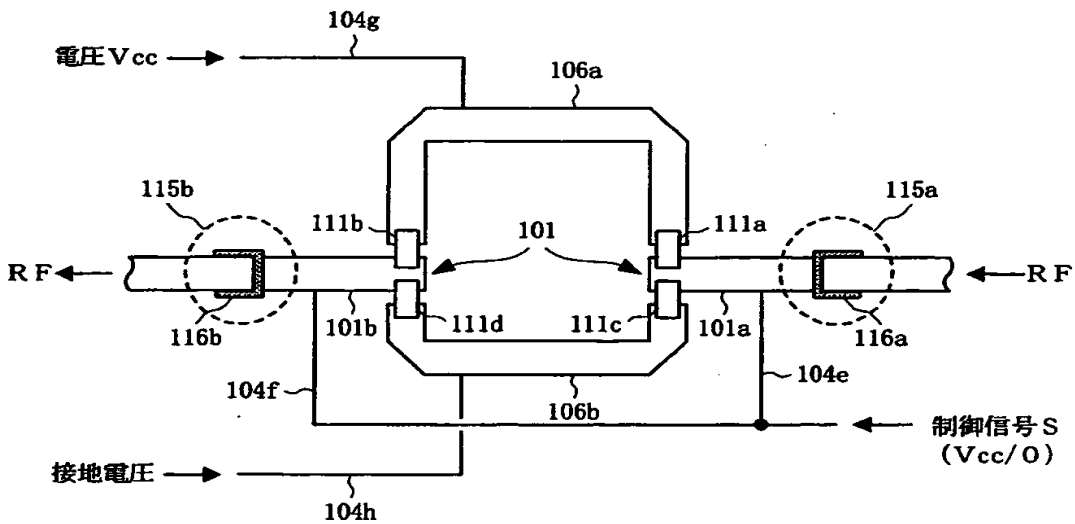
【図 2 2】



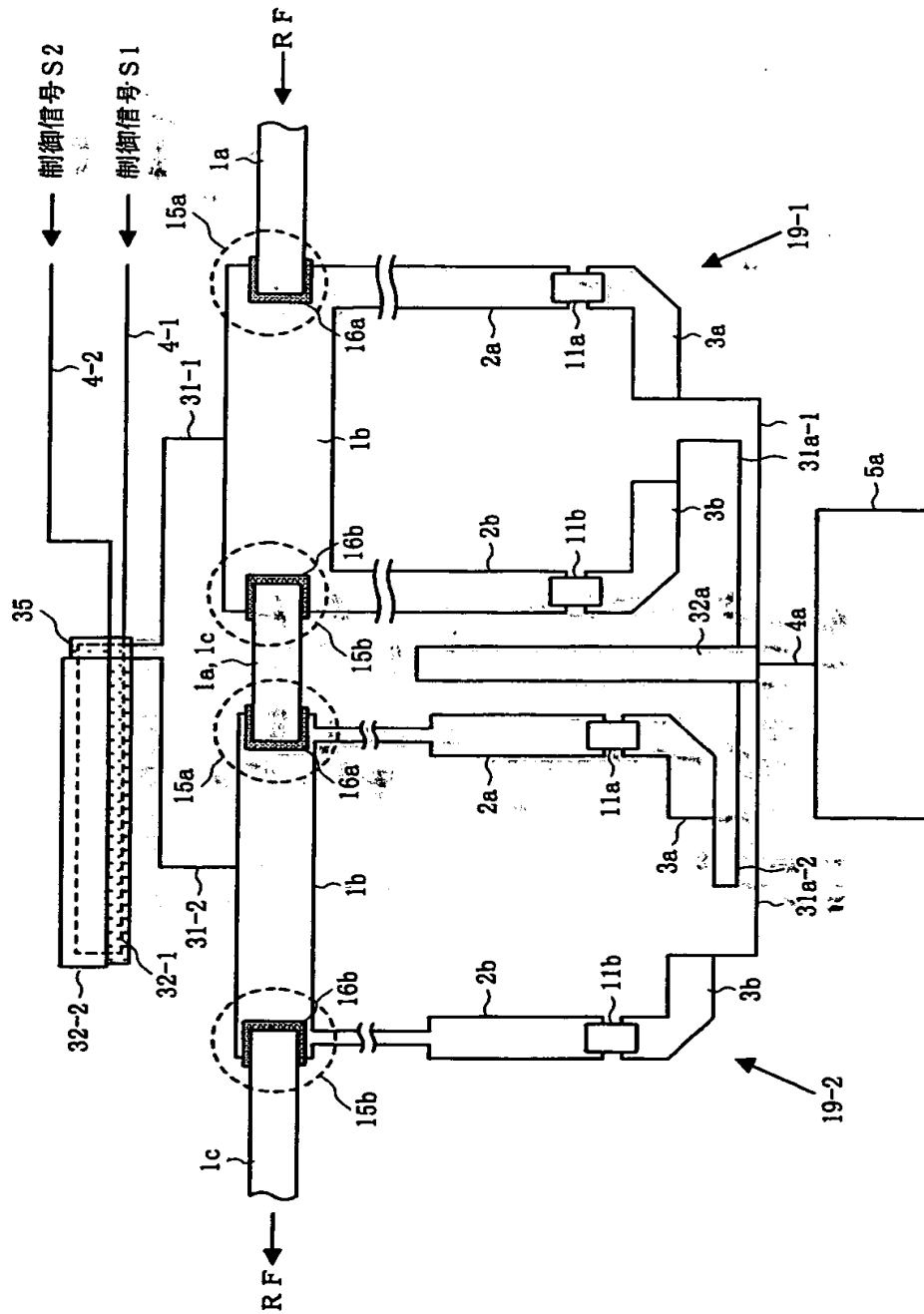
【図 2 3】



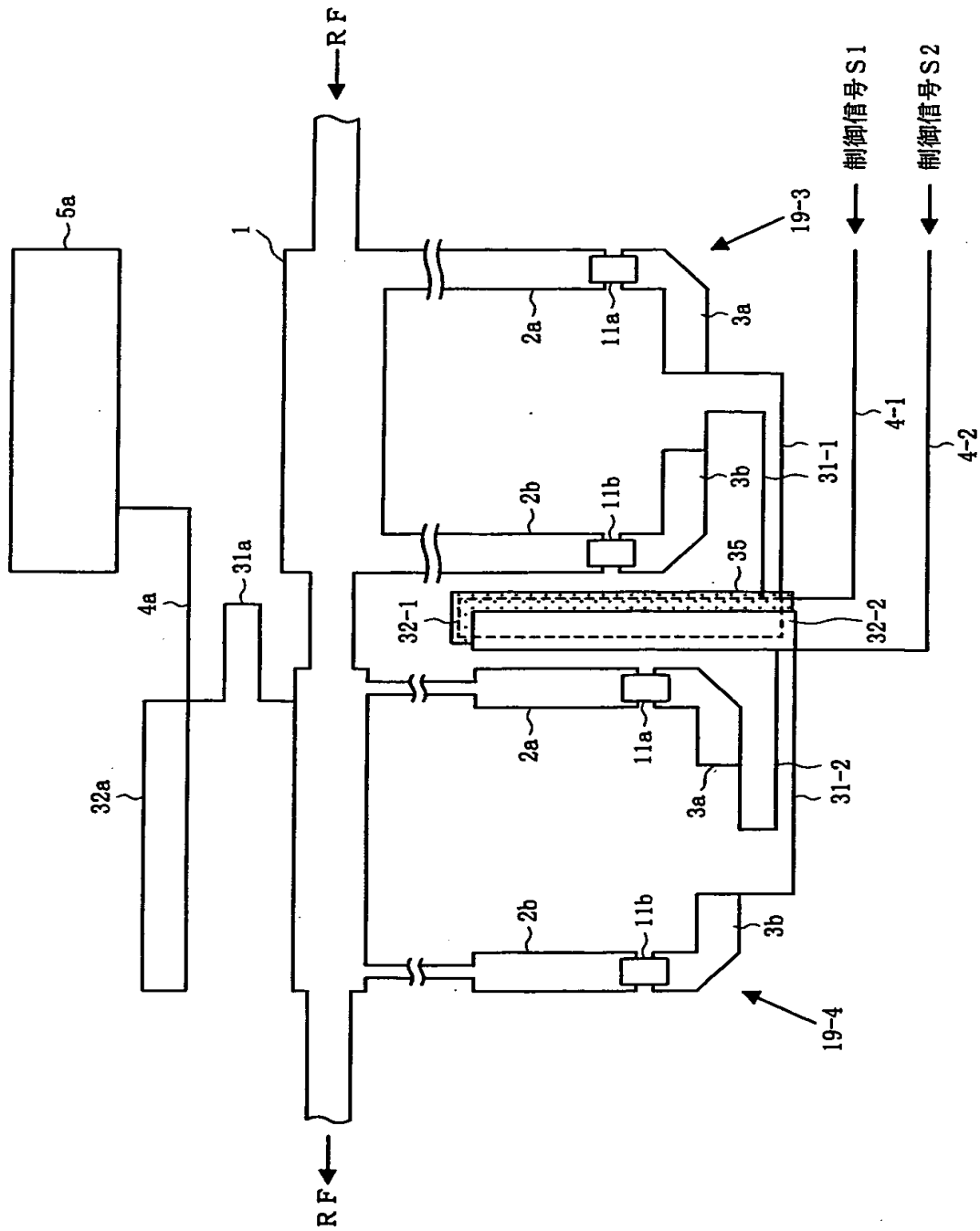
【図 2 4】



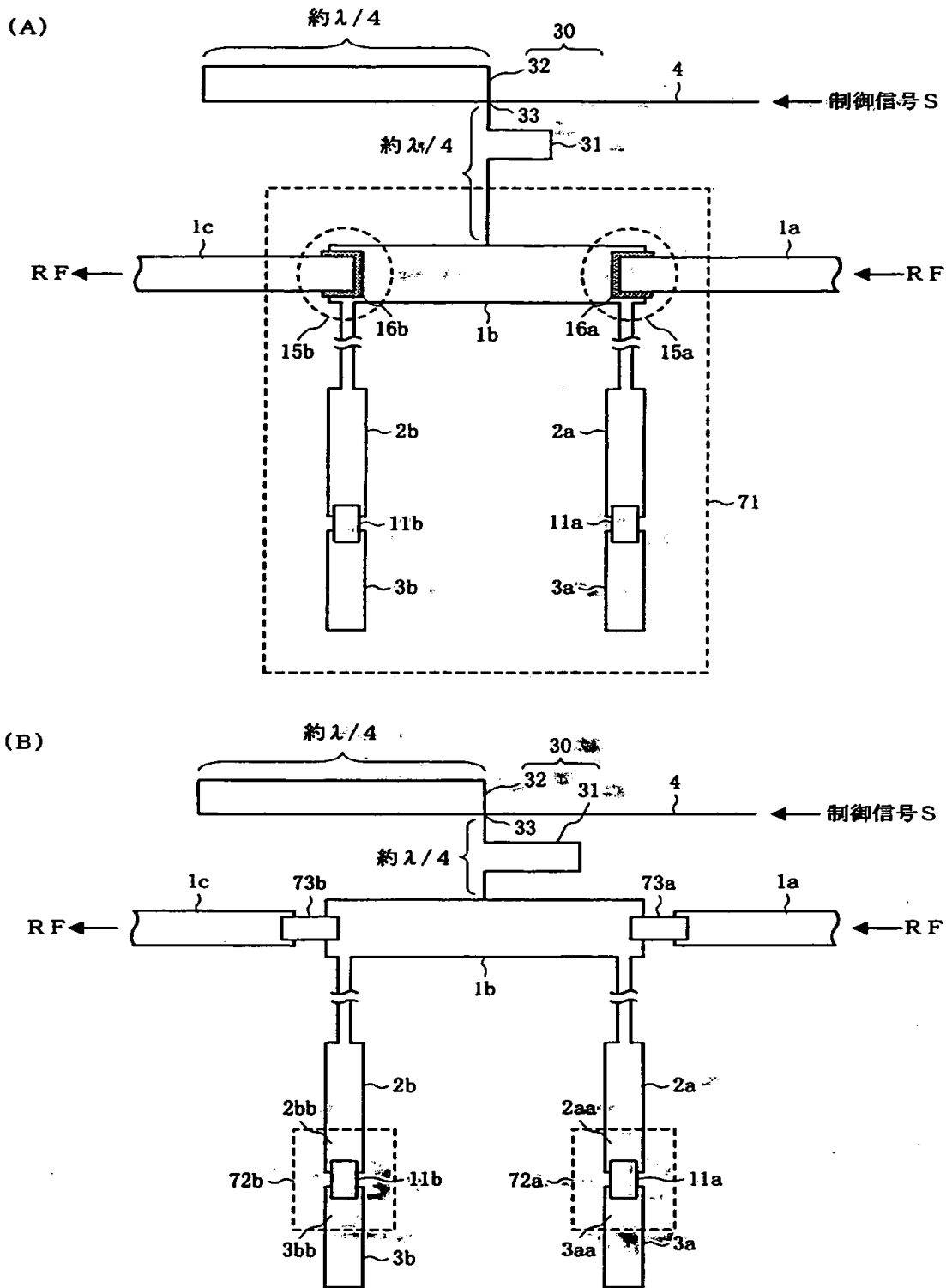
【図 2 5】



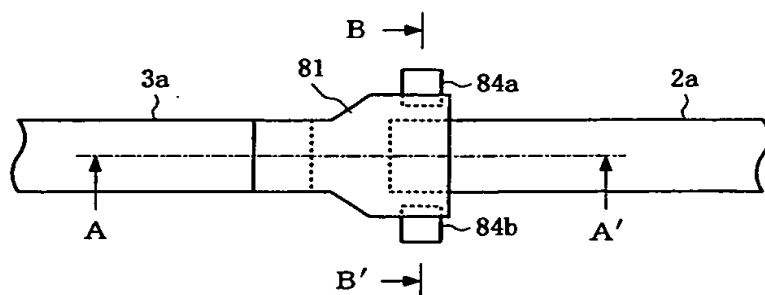
【図 2 6】



【図 2 7】

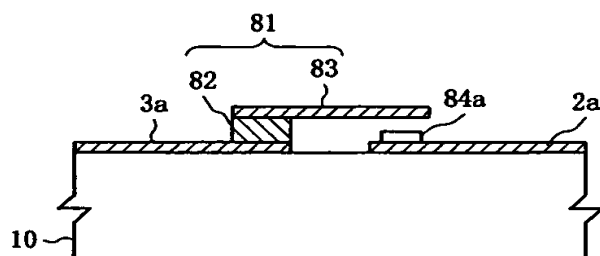


【図 2 8】

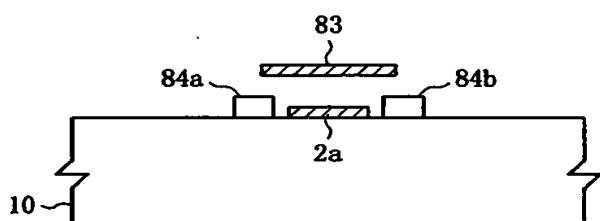


【図 2 9】

(A)

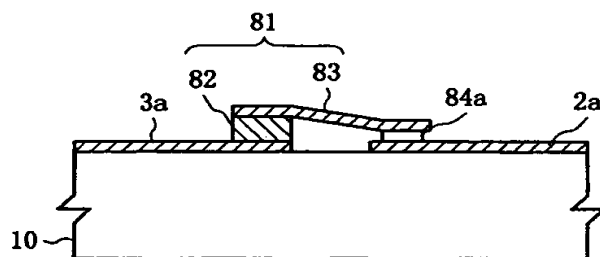


(B)

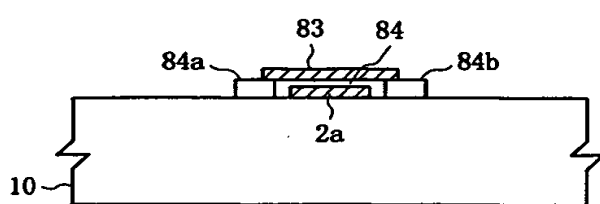


【図 3 0】

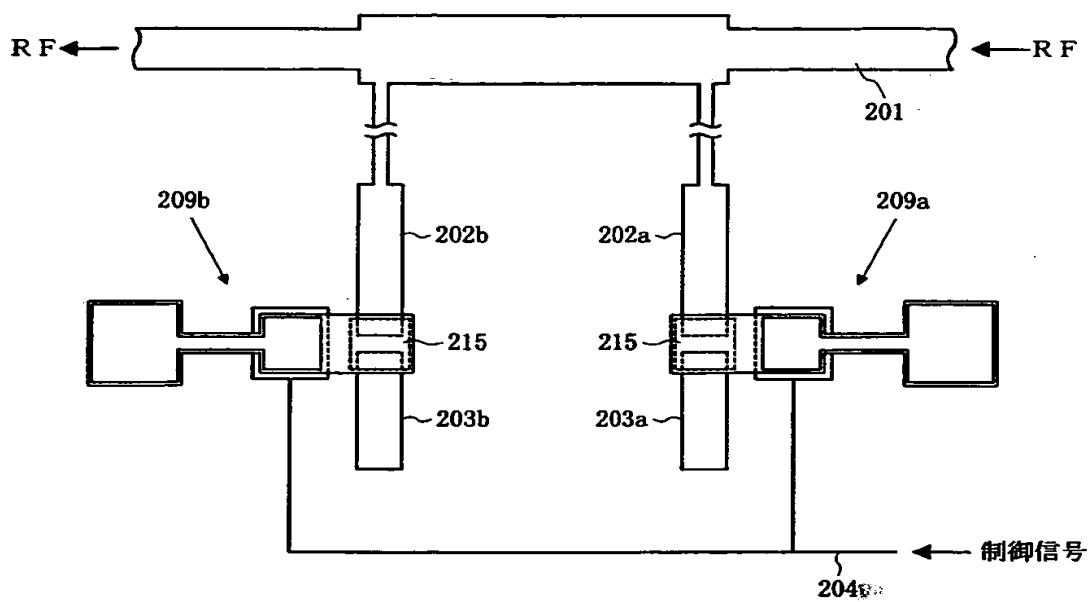
(A)



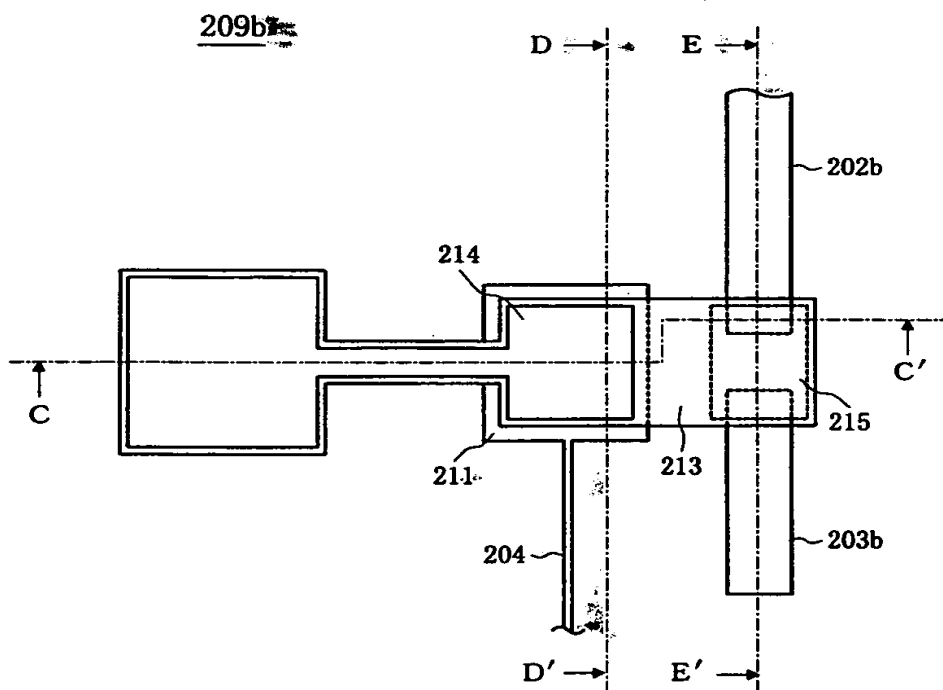
(B)



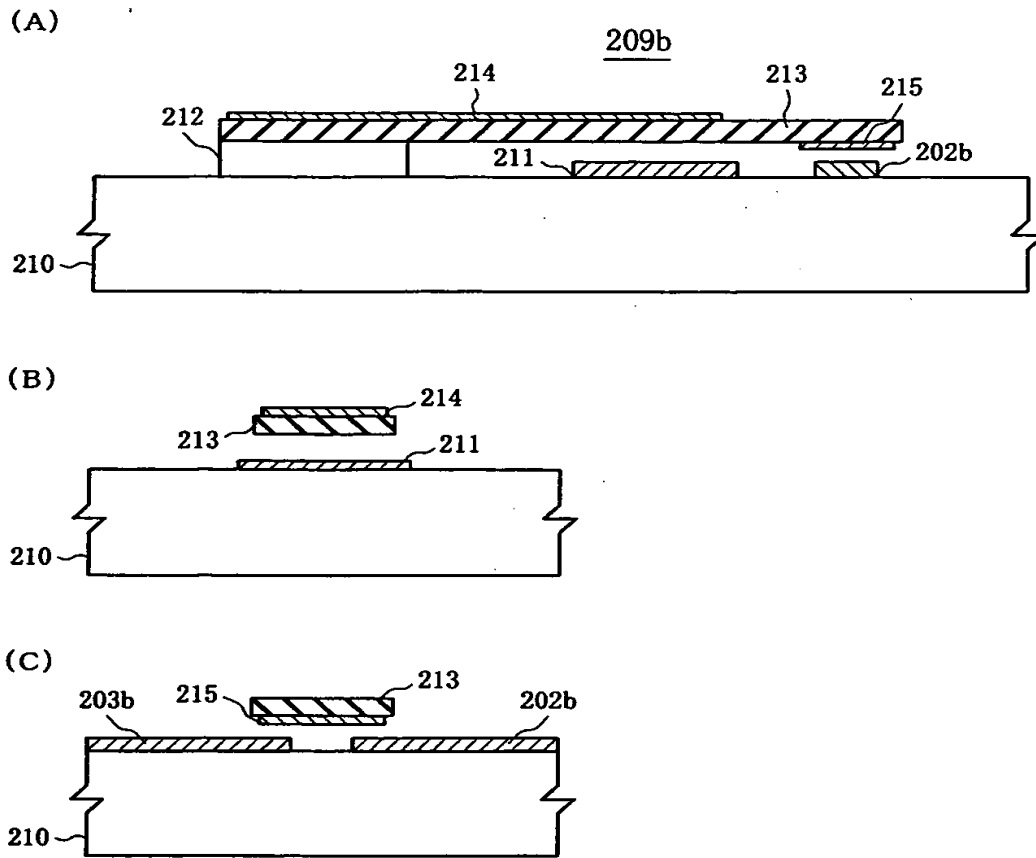
【図 3 1】



【図 3 2】



【図 3 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 スイッチング素子としてマイクロマシンスイッチを使用する移相器を小型化する。

【解決手段】 一端が第 2 の分布定数線路 3 a, 3 b に固定されるとともに他端が第 1 の分布定数線路 2 a, 2 b と接離自在に形成されたカンチレバー 1 1 a, 1 1 b と、第 1 の分布定数線路 2 a, 2 b とカンチレバー 1 1 a, 1 1 b との対向領域に形成された第 1 の絶縁手段と、第 1 の絶縁手段と共に第 1 の制御信号 4 の電圧値を保持する第 2 の絶縁手段 1 5 a, 1 5 b を含むマイクロマシンスイッチを備える。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 9 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
氏 名	日本電気株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)